

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2020년 1월 9일 (09.01.2020)



(10) 국제공개번호
WO 2020/009442 A1

(51) 국제특허분류:
C07D 495/04 (2006.01) *C07D 307/91* (2006.01)
C07D 411/14 (2006.01) *H01L 51/00* (2006.01)
C07D 209/82 (2006.01) *H01L 51/50* (2006.01)

(21) 국제출원번호: PCT/KR2019/008072

(22) 국제출원일: 2019년 7월 2일 (02.07.2019)

(25) 출원언어: 한국어

(26) 공개언어: 한국어

(30) 우선권정보:
10-2018-0077237 2018년 7월 3일 (03.07.2018) KR
10-2019-0078377 2019년 6월 28일 (28.06.2019) KR

(71) 출원인: 주식회사 엘지화학 (**LG CHEM, LTD.**) [KR/
KR]; 07336 서울시 영등포구 여의대로 128, Seoul (KR).

(72) 발명자: 정민우 (**JUNG, Min Woo**); 34122 대전시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원, Daejeon (KR). 이
동훈 (**LEE, Dong Hoon**); 34122 대전시 유성구 문지로
188 LG화학 기술연구원, Daejeon (KR). 장분재 (**JANG,
Boonjae**); 34122 대전시 유성구 문지로 188 LG화학 기
술연구원, Daejeon (KR). 이정하 (**LEE, Jungha**); 34122
대전시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원, Dae-
jeon (KR). 한수진 (**HAN, Su Jin**); 34122 대전시 유성
구 문지로 188 LG화학 기술연구원, Daejeon (KR). 박슬
찬 (**PARK, Seulchan**); 34122 대전시 유성구 문지로 188
LG화학 기술연구원, Daejeon (KR). 황성현 (**HWANG,
Sunghyun**); 34122 대전시 유성구 문지로 188 LG화학 기
술연구원, Daejeon (KR).

(74) 대리인: 유미특허법인 (**YOU ME PATENT AND LAW
FIRM**); 06134 서울시 강남구 테헤란로 115, Seoul (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국
내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC,
EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU,
ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ,

LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK,
MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA,
PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역
내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE,
LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유
럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK,
MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

(54) Title: NOVEL COMPOUND AND ORGANIC LIGHT EMITTING DEVICE USING SAME

(54) 발명의 명칭: 신규한 화합물 및 이를 이용한 유기 발광 소자

【도 1】

4
3
2
1

(57) Abstract: The present invention provides a novel compound and
an organic light emitting device using same.

(57) 요약서: 본 발명은 신규한 화합물 및 이를 이용한 유
기 발광 소자를 제공한다.

WO 2020/009442 A1

【발명의 명칭】

신규한 화합물 및 이를 이용한 유기 발광 소자

【기술분야】

관련 출원(들)과의 상호 인용

5 본 출원은 2018년 7월 3일자 한국 특허 출원 제10-2018-0077237호 및 2019년 6월 28일자 한국 특허 출원 제10-2019-0078377호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원들의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.

10 본 발명은 신규한 화합물 및 이를 포함하는 유기 발광 소자에 관한 것이다.

【배경기술】

 일반적으로 유기 발광 현상이란 유기 물질을 이용하여 전기에너지를 빛에너지로 전환시켜주는 현상을 말한다. 유기 발광 현상을 이용하는 유기
15 발광 소자는 넓은 시야각, 우수한 콘트라스트, 빠른 응답 시간을 가지며, 휘도, 구동 전압 및 응답 속도 특성이 우수하여 많은 연구가 진행되고 있다.

 유기 발광 소자는 일반적으로 양극과 음극 및 상기 양극과 음극 사이에 유기물층을 포함하는 구조를 가진다. 상기 유기물층은 유기 발광
20 소자의 효율과 안정성을 높이기 위하여 각기 다른 물질로 구성된 다층의 구조로 이루어진 경우가 많으며, 예컨대 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층, 전자주입층 등으로 이루어질 수 있다. 이러한 유기 발광 소자의 구조에서 두 전극 사이에 전압을 걸어주게 되면 양극에서는 정공이,
 음극에서는 전자가 유기물층에 주입되게 되고, 주입된 정공과 전자가
25 만났을 때 엑시톤(exciton)이 형성되며, 이 엑시톤이 다시 바닥상태로 떨어질 때 빛이 나게 된다.

 상기와 같은 유기 발광 소자에 사용되는 유기물에 대하여 새로운 재료의 개발이 지속적으로 요구되고 있다.

30 **【선행기술문헌】**

【특허문헌】

(특허문헌 1) 한국특허 공개번호 제10-2000-0051826호

【발명의 내용】

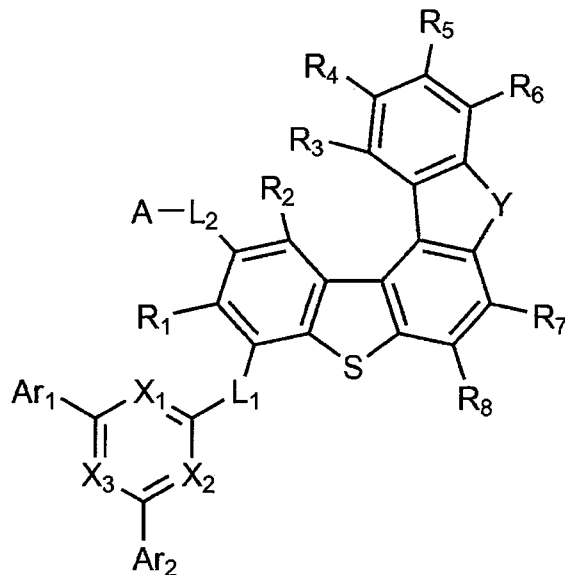
【해결하려는 과제】

- 5 본 발명은 신규한 화합물 및 이를 포함하는 유기 발광 소자에 관한 것이다.

【과제의 해결 수단】

본 발명은 하기 화학식 1로 표시되는 화합물을 제공한다:

[화학식 1]



10

상기 화학식 1에서,

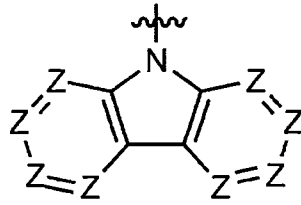
X_1 내지 X_3 는 각각 독립적으로, N 또는 CH이되, X_1 내지 X_3 중 적어도 둘은 N이고,

Y는 O 또는 S이고,

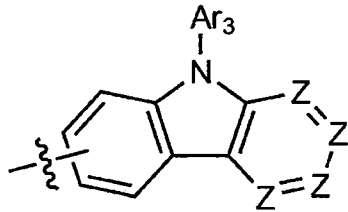
- 15 L_1 및 L_2 는 각각 독립적으로, 단일 결합; 치환 또는 비치환된 C_{6-60} 아릴렌; 또는 치환 또는 비치환된 O, N, Si 및 S로 구성되는 군으로부터 선택되는 헤테로원자를 1개 이상을 포함하는 C_{2-60} 헤테로아릴렌이고,

A는 하기 화학식 2 또는 3으로 표시되고,

[화학식 2]



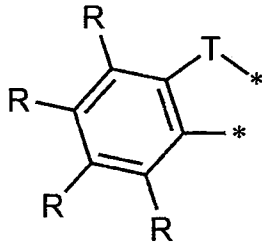
[화학식 3]



상기 화학식 2 및 3에서,

- 5 Z는 각각 독립적으로 CR이거나; 또는 Z 중 이웃하는 2개는 하기 화학식 4와 연결되어 융합고리를 형성하는 C이고, 나머지는 각각 독립적으로 CR이고,

[화학식 4]



- 10 상기 화학식 4에서,

T는 O, S, CQ₁Q₂, 또는 NAr₄이고,

Ar₁ 내지 Ar₄는 각각 독립적으로, 치환 또는 비치환된 C₆₋₆₀ 아릴; 또는 치환 또는 비치환된 N, O 및 S로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나 이상을 포함하는 C₂₋₆₀ 헤테로아릴이고,

- 15 R 및 R₁ 내지 R₈은 각각 독립적으로, 수소; 중수소; 할로젠; 시아노; 니트로; 아미노; 치환 또는 비치환된 C₁₋₆₀ 알킬; 치환 또는 비치환된 C₁₋₆₀ 할로알킬; 치환 또는 비치환된 C₁₋₆₀ 알콕시; 치환 또는 비치환된 C₁₋₆₀ 할로알콕시; 치환 또는 비치환된 C₃₋₆₀ 사이클로알킬; 치환 또는 비치환된 C₂₋₆₀ 알케닐; 치환 또는 비치환된 C₆₋₆₀ 아릴; 치환 또는 비치환된 C₆₋₆₀ 아릴옥시; 또는 치환 또는 비치환된 N, O 및 S로 구성되는 군으로부터
20 선택되는 헤테로원자를 1개 이상 포함하는 C₂₋₆₀ 헤테로아릴이고,

Q₁ 및 Q₂는 각각 독립적으로, 수소; 중수소; 할로젠; 시아노; 니트로;

아미노; 치환 또는 비치환된 C_{1-60} 알킬; 또는 치환 또는 비치환된 C_{6-60} 아릴이고,

*는 상기 화학식 2 또는 3의 이웃하는 2개의 Z와 연결되는 위치를 나타낸다.

5

또한, 본 발명은 제1 전극; 상기 제1 전극과 대향하여 구비된 제2 전극; 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 구비된 1층 이상의 유기물층을 포함하는 유기 발광 소자로서, 상기 유기물층 중 1층 이상은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는, 유기 발광 소자를 제공한다.

10 【발명의 효과】

상술한 화학식 1로 표시되는 화합물은 유기 발광 소자의 유기물층의 재료로서 사용될 수 있으며, 유기 발광 소자에서 효율의 향상, 낮은 구동전압 및/또는 수명 특성을 향상시킬 수 있다.

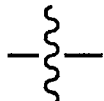
【도면의 간단한 설명】

15 도 1은 기판(1), 양극(2), 발광층(3), 음극(4)으로 이루어진 유기 발광 소자의 예를 도시한 것이다.

도 2는 기판 (1), 양극(2), 정공주입층(5), 정공수송층(6), 전자저지층(7), 발광층(3), 전자수송층(8), 전자주입층(9) 및 음극(4)으로 이루어진 유기 발광 소자의 예를 도시한 것이다.

20 【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 본 발명의 이해를 돕기 위하여 보다 상세히 설명한다.

본 명세서에서, 는 다른 치환기에 연결되는 결합을 의미하고, 단일 결합은 L_1 및 L_2 로 표시되는 부분에 별도의 원자가 존재하지 않은 경우를 의미한다.

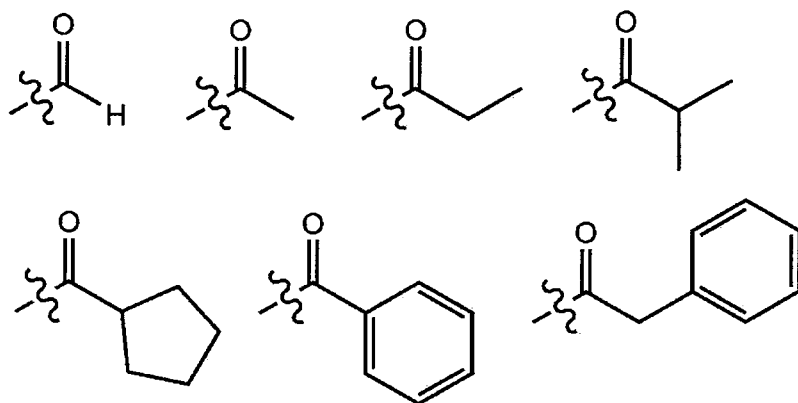
25

본 명세서에서 "치환 또는 비치환된"이라는 용어는 중수소; 할로젠기; 시아노기; 니트로기; 히드록시기; 카보닐기; 에스테르기; 이미드기; 아미노기; 포스핀옥사이드기; 알콕시기; 아릴옥시기; 알킬티옥시기; 아릴티옥시기; 알킬술폰시기; 아릴술폰시기; 실릴기; 붕소가;

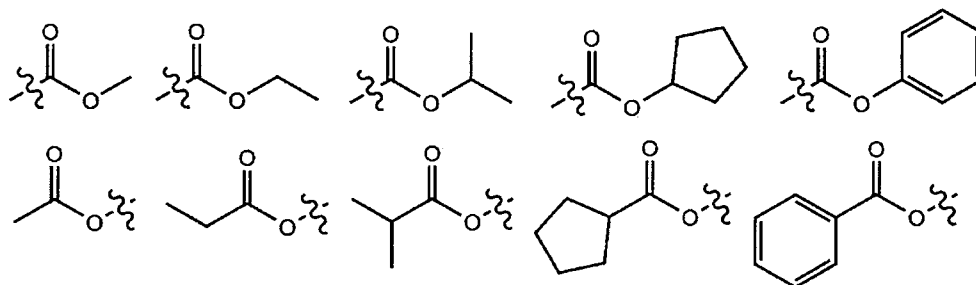
30

- 알킬기; 사이클로알킬기; 알케닐기; 아릴기; 아르알킬기; 아르알케닐기; 알킬아릴기; 알킬아민기; 아랄킬아민기; 헤테로아릴아민기; 아릴아민기; 아릴포스핀기; 또는 N, O 및 S 원자 중 1개 이상을 포함하는 헤테로아릴로 이루어진 군에서 선택된 1개 이상의 치환기로 치환 또는 비치환되거나,
- 5 상기 예시된 치환기 중 2 이상의 치환기가 연결된 치환 또는 비치환된 것을 의미한다. 예컨대, "2 이상의 치환기가 연결된 치환기"는 비페닐기일 수 있다. 즉, 비페닐이기는 아릴기일 수도 있고, 2개의 페닐기가 연결된 치환기로 해석될 수도 있다.

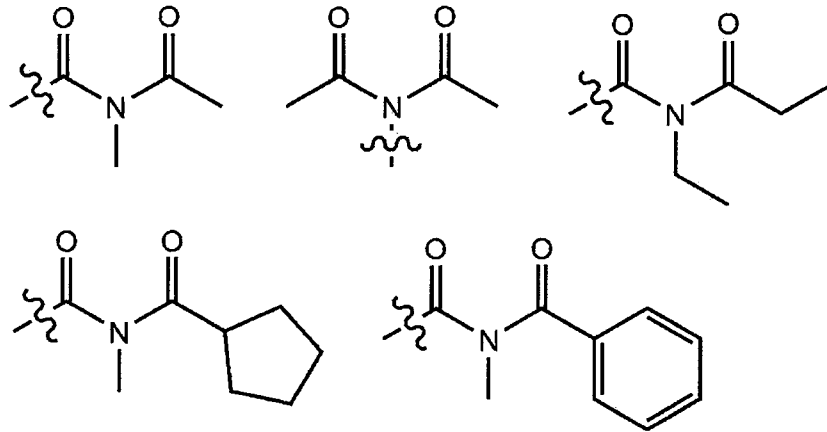
- 10 본 명세서에서 카보닐기의 탄소수는 특별히 한정되지 않으나, 탄소수 1 내지 40인 것이 바람직하다. 구체적으로 하기와 같은 구조의 화합물이 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.



- 15 본 명세서에 있어서, 에스테르기는 에스테르기의 산소가 탄소수 1 내지 25의 직쇄, 분지쇄 또는 고리쇄 알킬기 또는 탄소수 6 내지 25의 아릴기로 치환될 수 있다. 구체적으로, 하기 구조식의 화합물이 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.



본 명세서에 있어서, 이미드기의 탄소수는 특별히 한정되지 않으나, 탄소수 1 내지 25인 것이 바람직하다. 구체적으로 하기와 같은 구조의 화합물이 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.



5

본 명세서에 있어서, 실릴기는 구체적으로 트리메틸실릴기, 트리에틸실릴기, t-부틸디메틸실릴기, 비닐디메틸실릴기, 프로필디메틸실릴기, 트리페닐실릴기, 디페닐실릴기, 페닐실릴기 등이 있으나 이에 한정되지 않는다.

10

본 명세서에 있어서, 붕소기는 구체적으로 트리메틸붕소기, 트리에틸붕소기, t-부틸디메틸붕소기, 트리페닐붕소기, 페닐붕소기 등이 있으나 이에 한정되지 않는다.

15 본 명세서에 있어서, 할로겐기의 예로는 불소, 염소, 브롬 또는 요오드가 있다.

20 본 명세서에 있어서, 상기 알킬기는 직쇄 또는 분지쇄일 수 있고, 탄소수는 특별히 한정되지 않으나 1 내지 40인 것이 바람직하다. 일 실시상태에 따르면, 상기 알킬기의 탄소수는 1 내지 20이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 알킬기의 탄소수는 1 내지 10이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 알킬기의 탄소수는 1 내지 6이다. 알킬기의 구체적인 예로는 메틸, 에틸, 프로필, n-프로필, 이소프로필, 부틸, n-부틸,

이소부틸, tert-부틸, sec-부틸, 1-메틸-부틸, 1-에틸-부틸, 펜틸, n-펜틸, 이소펜틸, 네오펜틸, tert-펜틸, 헥실, n-헥실, 1-메틸펜틸, 2-메틸펜틸, 4-메틸-2-펜틸, 3,3-디메틸부틸, 2-에틸부틸, 헵틸, n-헵틸, 1-메틸헥실, 사이클로펜틸메틸, 사이클로헥틸메틸, 옥틸, n-옥틸, tert-옥틸, 1-메틸헵틸, 2-에틸헥실, 2-프로필펜틸, n-노닐, 2,2-디메틸헵틸, 1-에틸-프로필, 1,1-디메틸-프로필, 이소헥실, 2-메틸펜틸, 4-메틸헥실, 5-메틸헥실 등이 있으나, 이들에 한정되지 않는다.

본 명세서에 있어서, 상기 알케닐기는 직쇄 또는 분지쇄일 수 있고, 탄소수는 특별히 한정되지 않으나, 2 내지 40인 것이 바람직하다. 일 실시상태에 따르면, 상기 알케닐기의 탄소수는 2 내지 20이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 알케닐기의 탄소수는 2 내지 10이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 알케닐기의 탄소수는 2 내지 6이다. 구체적인 예로는 비닐, 1-프로페닐, 이소프로페닐, 1-부테닐, 2-부테닐, 3-부테닐, 1-펜테닐, 2-펜테닐, 3-펜테닐, 3-메틸-1-부테닐, 1,3-부타디에닐, 알릴, 1-페닐비닐-1-일, 2-페닐비닐-1-일, 2,2-디페닐비닐-1-일, 2-페닐-2-(나프틸-1-일)비닐-1-일, 2,2-비스(디페닐-1-일)비닐-1-일, 스티베닐기, 스티레닐기 등이 있으나 이들에 한정되지 않는다.

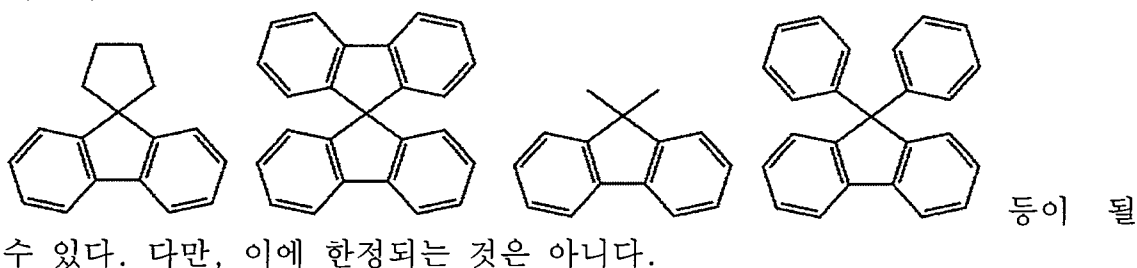
본 명세서에 있어서, 사이클로알킬기는 특별히 한정되지 않으나, 탄소수 3 내지 60인 것이 바람직하며, 일 실시상태에 따르면, 상기 사이클로알킬기의 탄소수는 3 내지 30이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 사이클로알킬기의 탄소수는 3 내지 20이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 사이클로알킬기의 탄소수는 3 내지 6이다. 구체적으로 사이클로프로필, 사이클로부틸, 사이클로펜틸, 3-메틸사이클로펜틸, 2,3-디메틸사이클로펜틸, 사이클로헥실, 3-메틸사이클로헥실, 4-메틸사이클로헥실, 2,3-디메틸사이클로헥실, 3,4,5-트리메틸사이클로헥실, 4-tert-부틸사이클로헥실, 사이클로헵틸, 사이클로옥틸 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.

30

본 명세서에 있어서, 아릴기는 특별히 한정되지 않으나 탄소수 6 내지 60인 것이 바람직하며, 단환식 아릴기 또는 다환식 아릴기일 수 있다. 일 실시상태에 따르면, 상기 아릴기의 탄소수는 6 내지 30이다. 일 실시상태에 따르면, 상기 아릴기의 탄소수는 6 내지 20이다. 상기 아릴기가

5 단환식 아릴기로는 페닐기, 비페닐이기, 터페닐기 등이 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 상기 다환식 아릴기로는 나프틸기, 안트라세닐기, 페난트릴기, 파이레닐기, 페릴레닐기, 크라이세닐기, 플루오레닐기 등이 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

10 본 명세서에 있어서, 플루오레닐기는 치환될 수 있고, 치환기 2개가 서로 결합하여 스피로 구조를 형성할 수 있다. 상기 플루오레닐기가 치환되는 경우,



15

본 명세서에 있어서, 헤테로아릴은 이종 원소로 O, N, Si 및 S 중 1개 이상을 포함하는 헤테로아릴로서, 탄소수는 특별히 한정되지 않으나, 탄소수 2 내지 60인 것이 바람직하다. 헤테로아릴의 예로는 티오펜기, 퓨란기, 피롤기, 이미다졸기, 티아졸기, 옥사졸기, 옥사디아졸기,

20 트리아졸기, 피리딘기, 비피리딘기, 피리미딘기, 트리아진기, 트리아졸기, 아크리딘기, 피리다진기, 피라지닐기, 퀴놀리닐기, 퀴나졸린기, 퀴녹살리닐기, 프탈라지닐기, 피리도 피리미디닐기, 피리도 피라지닐기, 피라지노 피라지닐기, 이소퀴놀린기, 인돌기, 카바졸기, 벤조옥사졸기, 벤조이미다졸기, 벤조티아졸기, 벤조카바졸기, 벤조티오펜기,

25 디벤조티오펜기, 벤조퓨라닐기, 페난쓰롤린기(phenanthroline), 티아졸릴기, 이소옥사졸릴기, 옥사디아졸릴기, 티아디아졸릴기, 벤조티아졸릴기, 페노티아지닐기 및 디벤조퓨라닐기 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.

본 명세서에 있어서, 아르알킬기, 아르알케닐기, 알킬아릴기, 아릴아민기 중의 아릴기는 전술한 아릴기의 예시와 같다. 본 명세서에 있어서, 아르알킬기, 알킬아릴기, 알킬아민기 중 알킬기는 전술한 알킬기의 예시와 같다. 본 명세서에 있어서, 헤테로아릴아민 중 헤테로아릴은 전술한 헤테로아릴에 관한 설명이 적용될 수 있다. 본 명세서에 있어서, 아르알케닐기 중 알케닐기는 전술한 알케닐기의 예시와 같다. 본 명세서에 있어서, 아릴렌은 2가기인 것을 제외하고는 전술한 아릴기에 관한 설명이 적용될 수 있다. 본 명세서에 있어서, 헤테로아릴렌은 2가기인 것을 제외하고는 전술한 헤테로아릴에 관한 설명이 적용될 수 있다. 본 명세서에 있어서, 탄화수소 고리는 1가기가 아니고, 2개의 치환기가 결합하여 형성한 것을 제외하고는 전술한 아릴기 또는 사이클로알킬기에 관한 설명이 적용될 수 있다. 본 명세서에 있어서, 헤테로고리는 1가기가 아니고, 2개의 치환기가 결합하여 형성한 것을 제외하고는 전술한 헤테로아릴에 관한 설명이 적용될 수 있다.

한편, 본 발명은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 제공한다.

상기 화학식 1에서,
 X_1 내지 X_3 는 N이거나,
 X_1 및 X_2 는 N이고, X_3 는 CH이거나, 또는
 X_1 및 X_3 는 N이고, X_2 는 CH일 수 있다.

또한, L_1 및 L_2 는 각각 독립적으로, 단일 결합, 치환 또는 비치환된 페닐렌, 치환 또는 비치환된 비페닐릴렌, 치환 또는 비치환된 나프틸렌, 치환 또는 비치환된 페난트레닐렌, 치환 또는 비치환된 안트라세닐렌, 치환 또는 비치환된 플루오란테닐렌, 치환 또는 비치환된 트리페닐레닐렌, 치환 또는 비치환된 파이레닐렌, 치환 또는 비치환된 카바졸일렌, 치환 또는 비치환된 플루오레닐렌, 또는 치환 또는 비치환된 스파이로-플루오레닐렌일 수 있다.

예를 들어, L_1 및 L_2 는 각각 독립적으로, 단일 결합, 페닐렌, 또는 비페닐릴렌일 수 있다.

5 이때, L_1 및 L_2 는 중 적어도 하나가 단일 결합일 수 있다.

또한, Ar_1 및 Ar_2 는 각각 독립적으로, 치환 또는 비치환된 C_{6-20} 아릴; 또는 치환 또는 비치환된 O, N 및 S로 구성되는 군으로부터 선택되는 헤테로원자를 1개 포함하는 C_{2-20} 헤테로아릴일 수 있다.

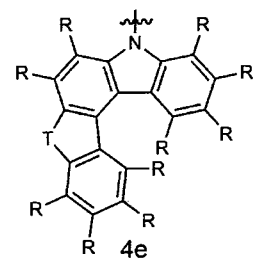
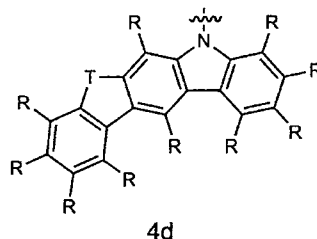
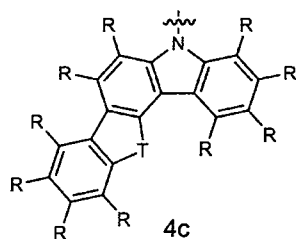
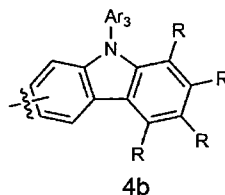
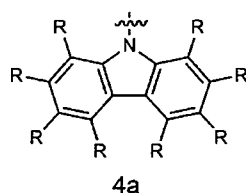
10

예를 들어, Ar_1 및 Ar_2 는 각각 독립적으로, 페닐, 비페닐릴, 터페닐릴, 나프틸, 페난쓰레닐, 디벤조티오펜, 또는 카바졸일일 수 있다.

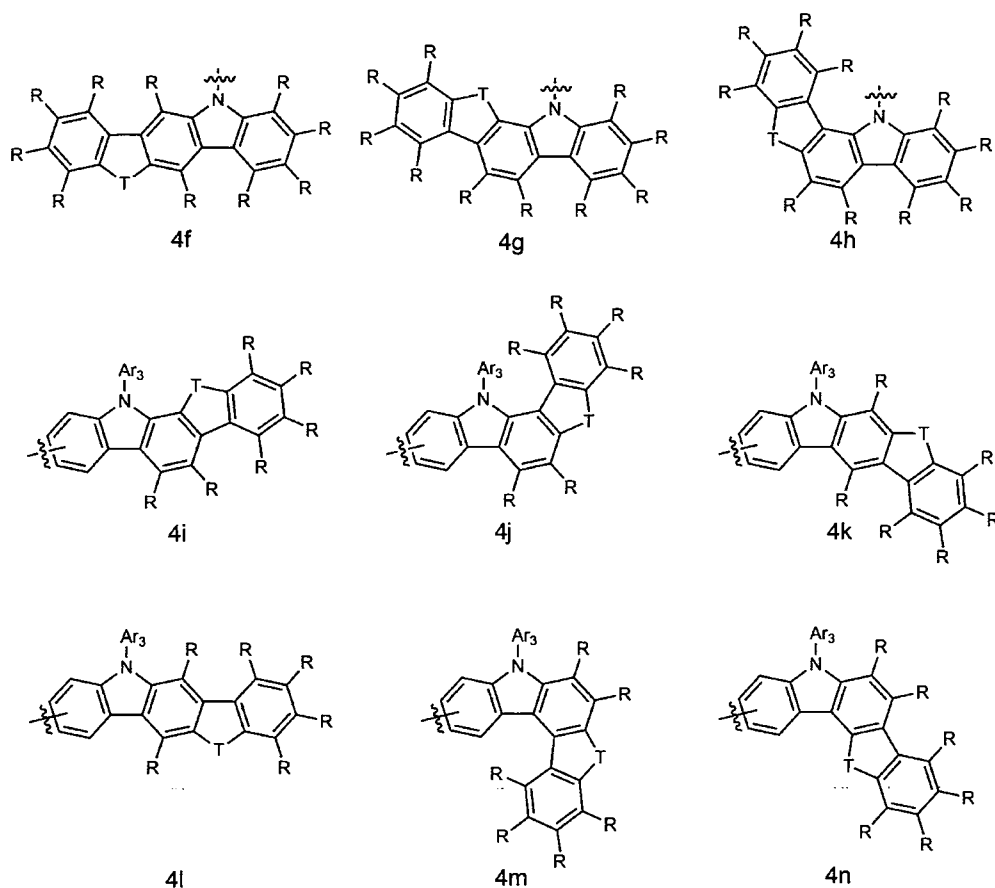
다르게는, Ar_1 및 Ar_2 는 모두 페닐일 수 있다.

15

또한, 상기 화학식 1에서 A는 상기 화학식 2 또는 3의 구조이거나, 상기 화학식 2 또는 3이 각각 화학식 4와 축합된 구조일 수 있고, 이러한 A는 구체적으로 하기 화학식 4a 내지 4n으로 표시될 수 있다:



20



상기 화학식 4a 내지 4n에서,

T, Ar₃ 및 R에 대한 설명은 상기 화학식 1에서 정의한 바와 같고,

5 화학식 내 치환기 R은 서로 동일하거나 상이할 수 있다.

예를 들어, 상기 화학식 4a 내지 4n에서,

T는 O, S, CQ₁Q₂, 또는 NAr₄이고,

Ar₃ 및 Ar₄는 각각 독립적으로, C₆₋₂₀ 아릴이고,

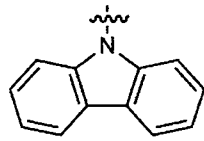
10 R은 각각 독립적으로, 수소, 또는 C₆₋₂₀ 아릴이고,

Q₁ 및 Q₂는 각각 독립적으로, 수소, C₁₋₁₀ 알킬, 또는 C₆₋₂₀ 아릴일 수 있다.

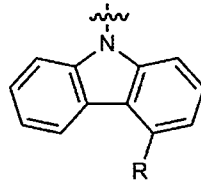
구체적으로 예를 들어, 상기 화학식 4a 내지 4n에서, Ar₃ 및 Ar₄는

15 페닐이고, R은 각각 독립적으로, 수소, 또는 페닐이고, Q₁ 및 Q₂는 메틸일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

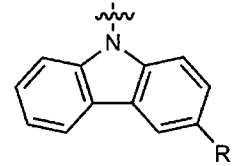
또는, A는 하기 5a 내지 5k로 표시되는 구조 중 선택되는 어느 하나일 수 있다:



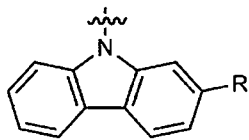
5a



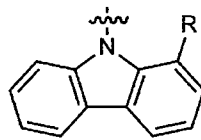
5b



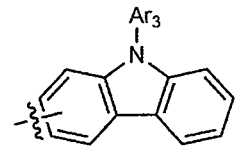
5c



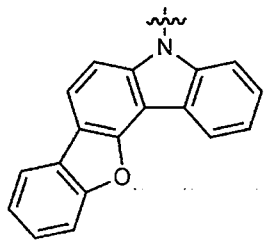
5d



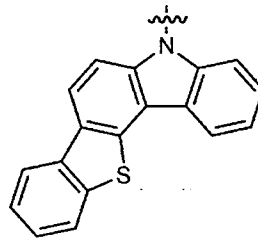
5e



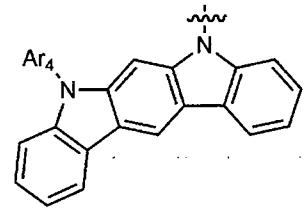
5f



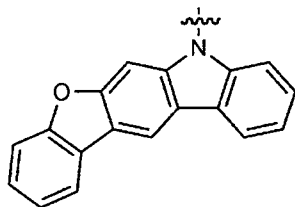
5g



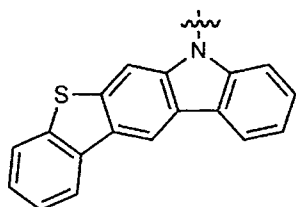
5h



5i



5j



5k

5

상기 화학식 5a 내지 5k에서,

R, Ar₃ 및 Ar₄에 대한 설명은 상기 화학식 1에서 정의한 바와 같다.

예를 들어, 상기 화학식 5a 내지 5k에서,

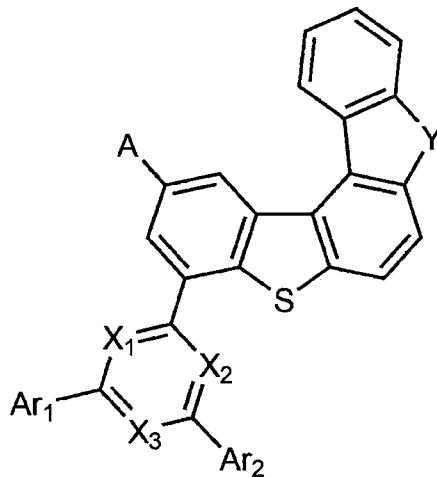
R, Ar₃ 및 Ar₄는 각각 독립적으로, C₆₋₂₀ 아릴일 수 있다.

구체적으로 예를 들어, 상기 화학식 5a 내지 5k에서, R, Ar₃ 및 Ar₄는 페닐일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

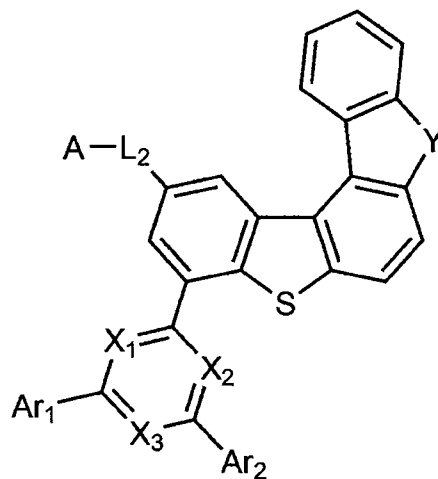
또한, R₁ 내지 R₈은 각각 독립적으로, 수소, 중수소, 할로젠, 시아노, 5 니트로, 아미노, C₁₋₂₀ 알킬, 또는 C₆₋₂₀ 아릴일 수 있다. 구체적으로, R₁ 내지 R₈은 모두 수소일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

또한, 상기 화합물은 하기 화학식 1-1 내지 1-3 중 어느 하나로 표시될 수 있다:

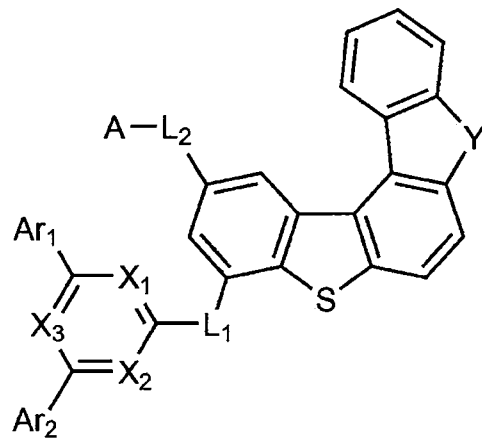
10 [화학식 1-1]



[화학식 1-2]



[화학식 1-3]

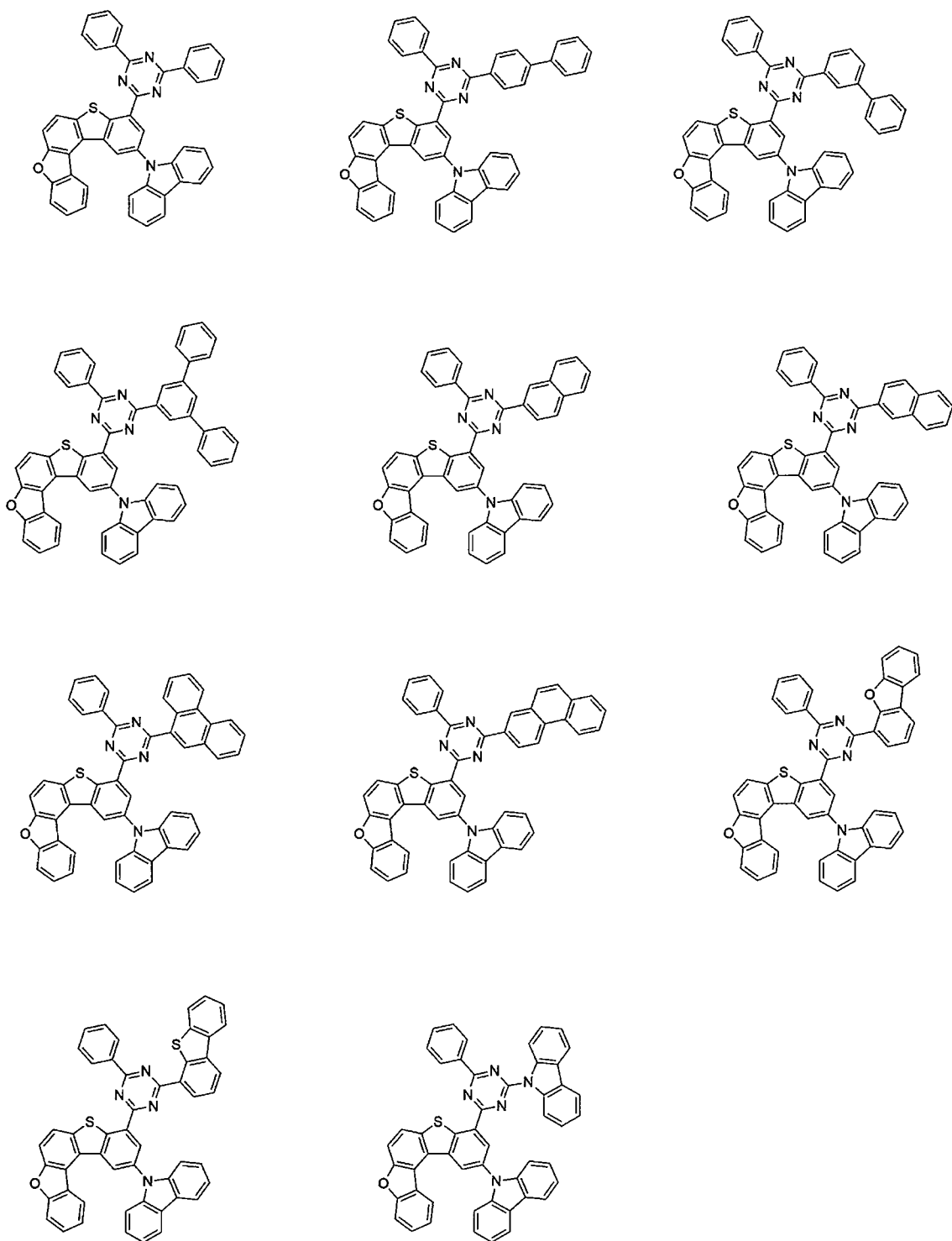


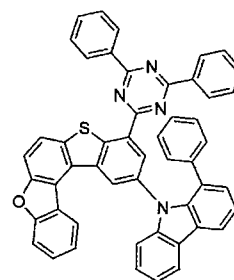
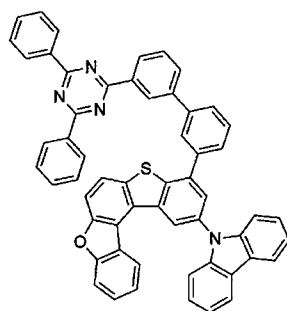
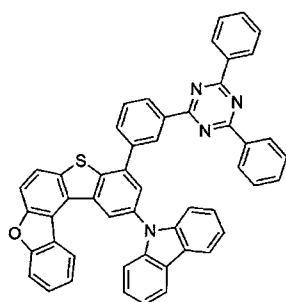
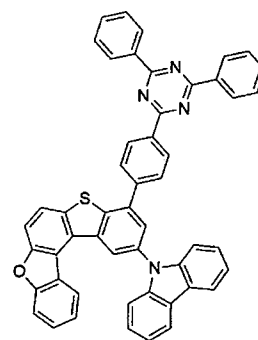
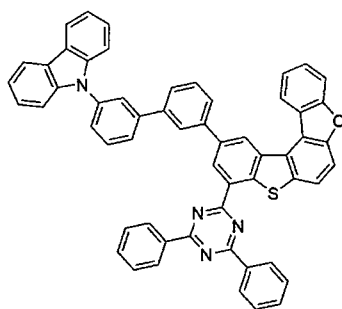
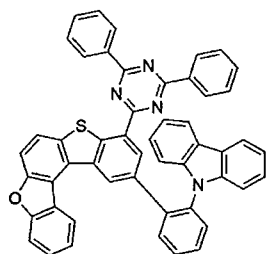
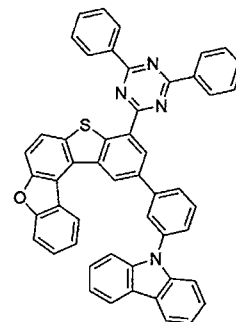
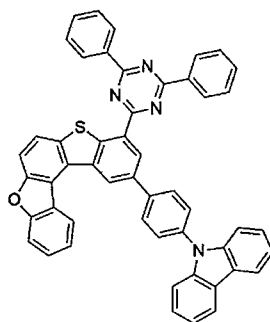
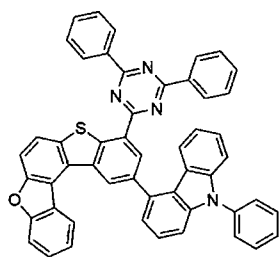
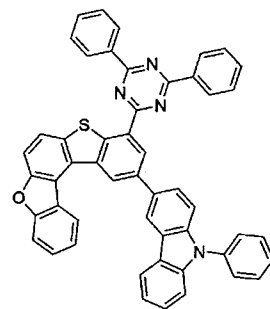
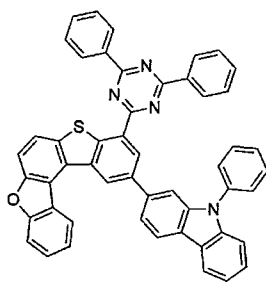
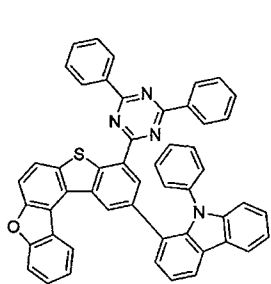
상기 화학식 1-1 내지 1-3에서,

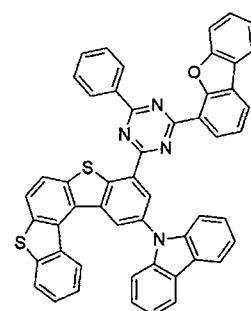
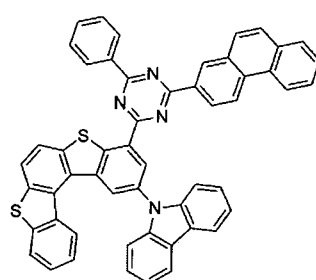
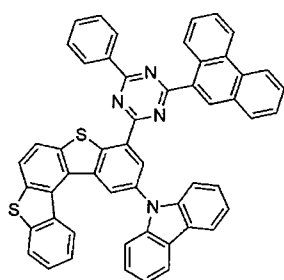
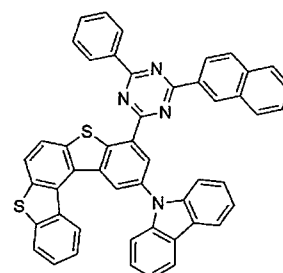
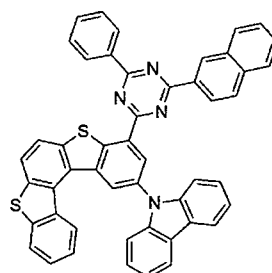
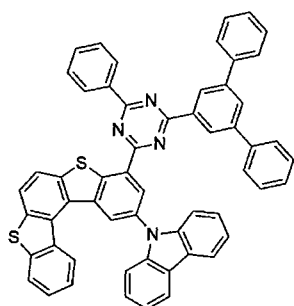
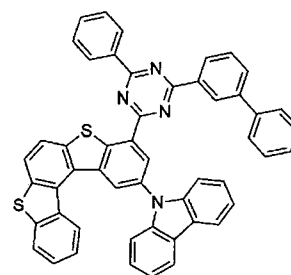
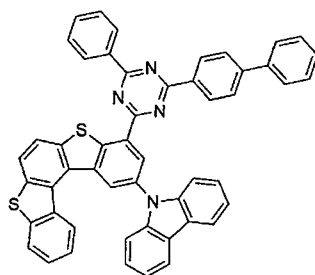
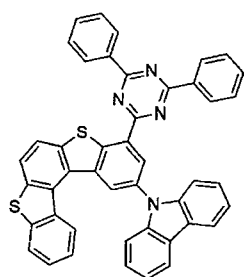
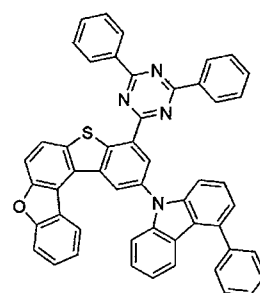
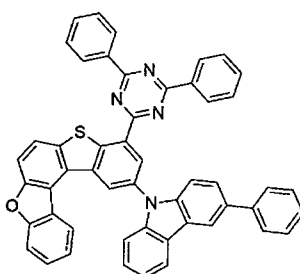
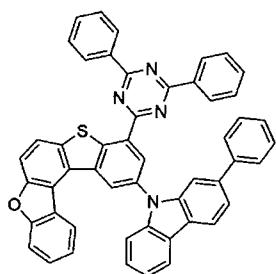
X_1 내지 X_3 , Y , L_1 , L_2 , A , Ar_1 및 Ar_2 에 대한 설명은 상기 화학식 1에서 정의한 바와 같다.

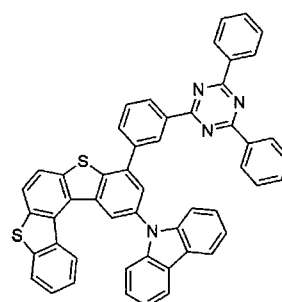
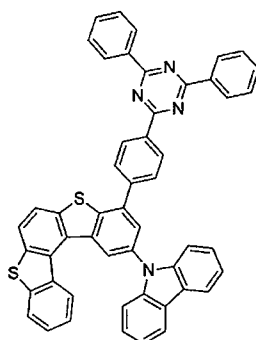
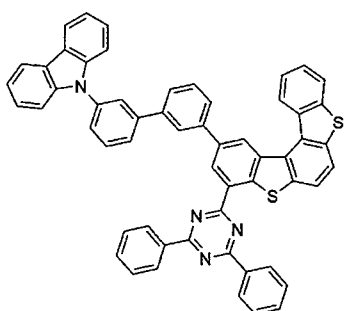
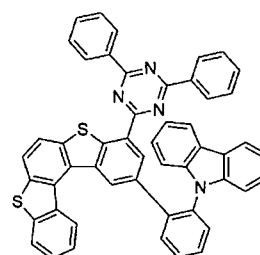
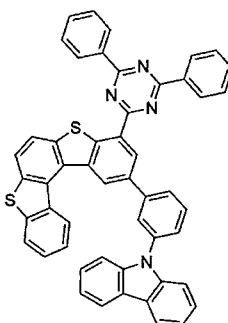
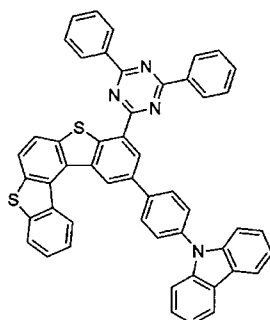
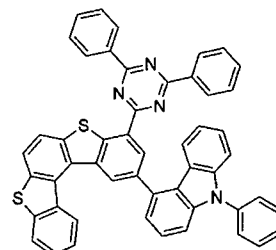
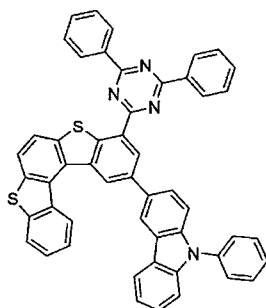
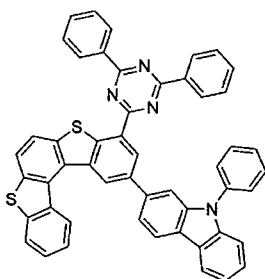
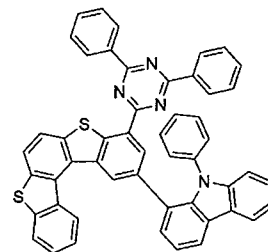
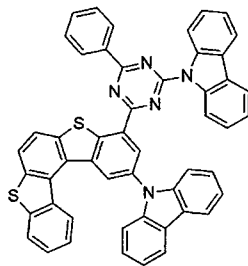
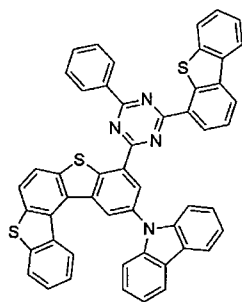
5

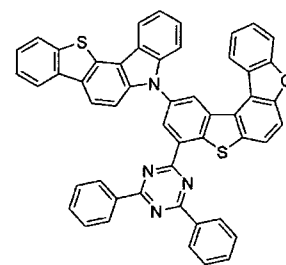
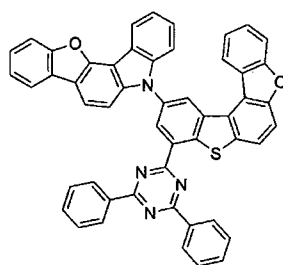
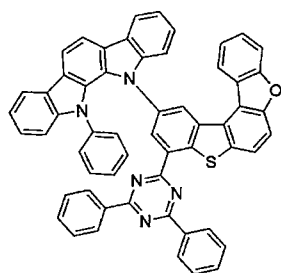
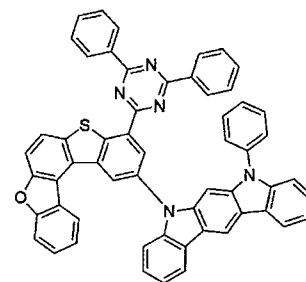
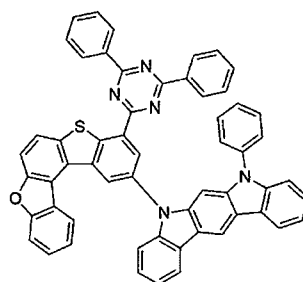
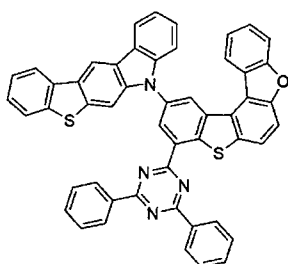
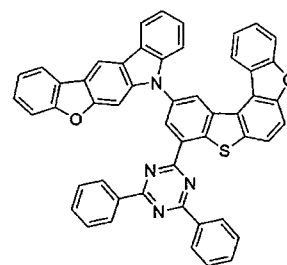
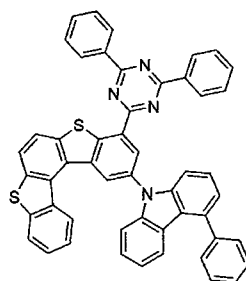
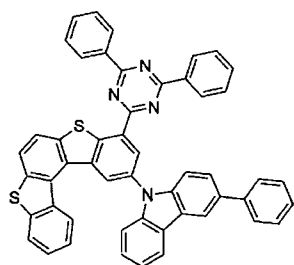
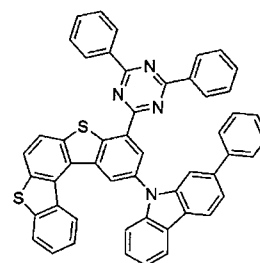
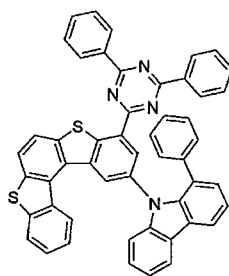
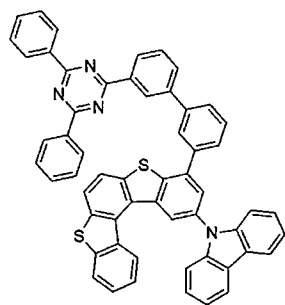
예를 들어, 상기 화합물은 하기 화합물로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나일 수 있다:

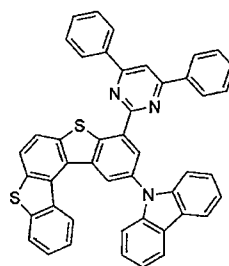
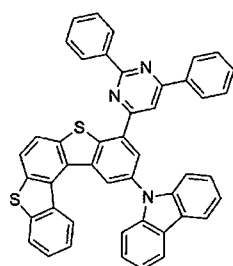
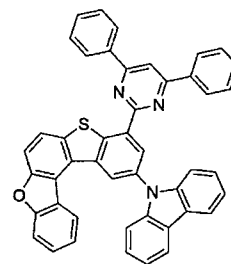
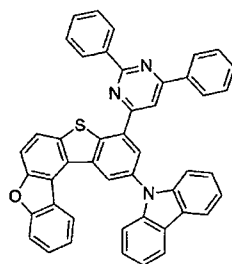
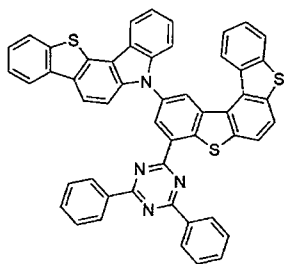
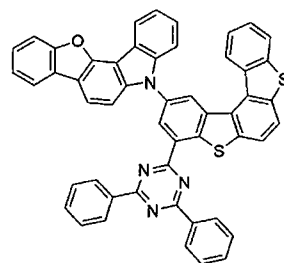
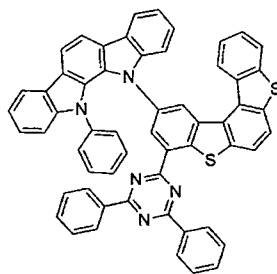
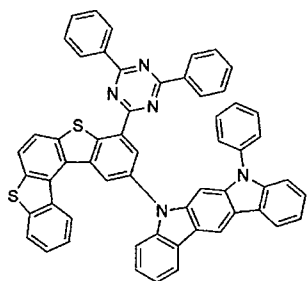
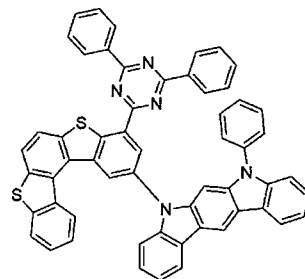
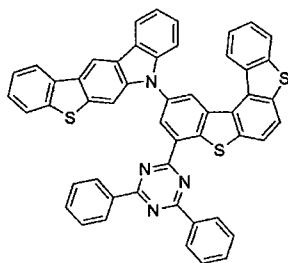
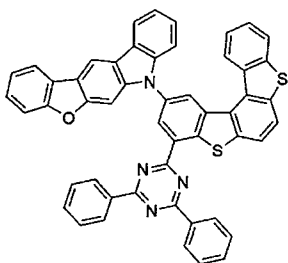








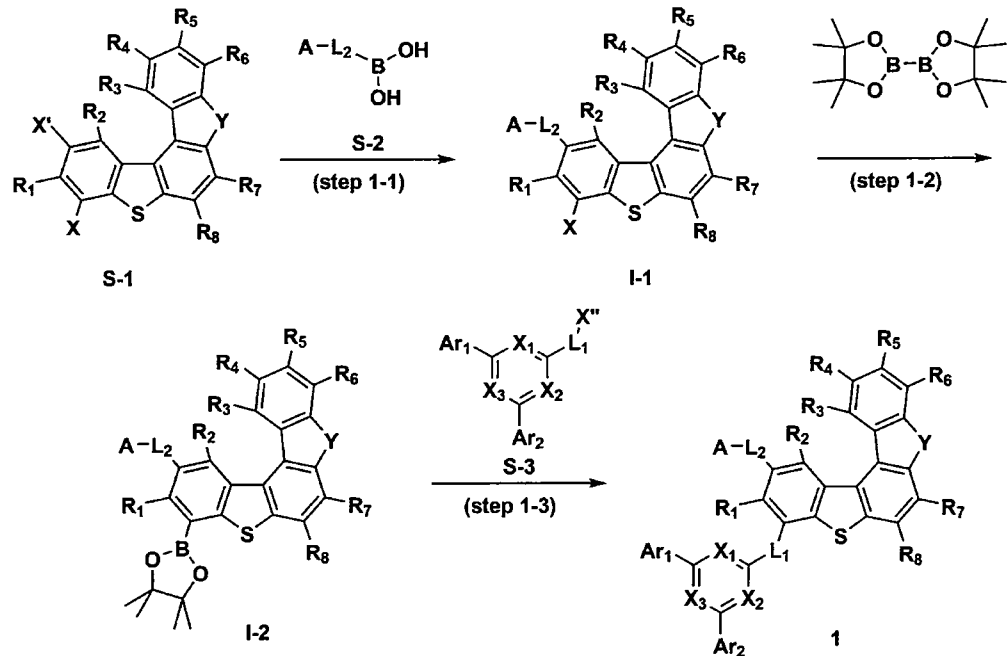




한편, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 일례로 하기 반응식 1과 같은 제조 방법으로 제조할 수 있다.

5

[반응식 1]



상기 반응식 1에서, X, X' 및 X'' 는 각각 독립적으로, 할로겐이고, 바람직하게는 브로모, 또는 클로로이며, 각 치환기에 대한 설명은 앞서
 5 정의한 바와 같다.

상기 단계 1-1은 출발물질 S-1에 카바졸계 치환기를 도입하여 중간체 화합물 I-1을 제조하는 단계이고, 상기 단계 1-2는 Suzuki-coupling 반응을 위한 반응기를 도입하여 중간체 화합물 I-2를 제조하는 단계이고, 상기 단계 1-3은 Suzuki-coupling 반응에 의해 트리아진계 치환기를 도입하여
 10 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 제조하는 단계이다. 이때, Suzuki-coupling 반응은 팔라듐 촉매 및 염기 하에서 수행되는 것이 바람직하며, 반응을 위한 반응기는 당해 기술 분야에서 알려진 반응기로 변경될 수 있다. 이러한 제조 방법은 후술할 제조예에서 보다 구체화될 수 있다.

상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 벤조퓨로디벤조티오펜 또는 벤조티에노디벤조티오펜 코어에 트리아진계 치환기 및 카바졸계 치환기가 동시에 결합된 구조를 가져, 이를 채용한 유기 발광 소자는 종래 벤조퓨로디벤조티오펜 또는 벤조티에노디벤조티오펜 코어를 갖는 화합물을 채용한 유기 발광 소자에 비하여, 고효율, 저 구동 전압, 고휘도 및 장수명
 20 등을 가질 수 있다.

한편, 본 발명은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는 유기 발광 소자를 제공한다. 일례로, 본 발명은 제1 전극; 상기 제1 전극과 대향하여 구비된 제2 전극; 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 구비된 1층 이상의 유기물층을 포함하는 유기 발광 소자로서, 상기 유기물층 중 1층 이상은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는, 유기 발광 소자를 제공한다.

본 발명의 유기 발광 소자의 유기물층은 단층 구조로 이루어질 수도 있으나, 2층 이상의 유기물층이 적층된 다층 구조로 이루어질 수 있다. 예컨대, 본 발명의 유기 발광 소자는 유기물층으로서 정공주입층, 정공수송층, 전자저지층, 발광층, 전자수송층, 전자주입층 등을 포함하는 구조를 가질 수 있다. 그러나 유기 발광 소자의 구조는 이에 한정되지 않고 더 적은 수의 유기층을 포함할 수 있다.

15

또한, 상기 유기물층은 발광층을 포함할 수 있고, 상기 발광층은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함한다. 특히, 본 발명에 따른 화합물은 발광층의 호스트로 사용할 수 있다. 구체적으로, 본 발명에 따른 화합물은 발광층의 녹색 인광 호스트로 사용할 수 있다.

20

또한, 상기 유기물층은 발광층을 포함할 수 있고, 상기 발광층은 2종 이상의 호스트를 포함하고, 이때 상기 호스트 중 하나가 상기 화학식 1로 표시되는 화합물일 수 있다.

25

또한, 상기 유기물층은 전자수송층, 또는 전자주입층을 포함할 수 있고, 상기 전자수송층, 또는 전자주입층은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함할 수 있다.

본 발명의 유기 발광 소자의 유기물 층은 단층 구조로 이루어질 수도 있으나, 2층 이상의 유기물층이 적층된 다층 구조로 이루어질 수 있다.

예컨대, 본 발명의 유기 발광 소자는 유기물 층으로서 발광층 이외에, 상기 제1전극과 상기 발광층 사이의 정공주입층 및 정공수송층, 및 상기 발광층과 상기 제2전극 사이의 전자수송층 및 전자주입층을 더 포함하는 구조를 가질 수 있다. 그러나 유기 발광 소자의 구조는 이에 한정되지 않고
5 더 적은 수 또는 더 많은 수의 유기층을 포함할 수 있다.

또한, 본 발명에 따른 유기 발광 소자는, 상기 제1 전극이 양극이고, 상기 제2전극이 음극인, 기판 상에 양극, 1층 이상의 유기물층 및 음극이 순차적으로 적층된 구조(normal type)의 유기 발광 소자일 수 있다. 또한,
10 본 발명에 따른 유기 발광 소자는, 상기 제1 전극이 음극이고, 상기 제2 전극이 양극인, 기판 상에 음극, 1층 이상의 유기물층 및 양극이 순차적으로 적층된 역방향 구조(inverted type)의 유기 발광 소자일 수 있다. 예컨대, 본 발명의 일실시예에 따른 유기 발광 소자의 구조는 도 1 및 2에 예시되어 있다.

15

도 1은 기판(1), 양극(2), 발광층(3), 음극(4)으로 이루어진 유기 발광 소자의 예를 도시한 것이다. 이와 같은 구조에 있어서, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 상기 발광층에 포함될 수 있다.

20 도 2는 기판 (1), 양극(2), 정공주입층(5), 정공수송층(6), 전자저지층(7), 발광층(3), 전자수송층(8), 전자주입층(9) 및 음극(4)으로 이루어진 유기 발광 소자의 예를 도시한 것이다. 이와 같은 구조에 있어서, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 상기 정공주입층, 정공수송층, 발광층 및 전자수송층 중 1층 이상에 포함될 수 있다. 바람직하게는, 상기 화학식
25 1로 표시되는 화합물은 상기 발광층에 포함될 수 있다.

본 발명에 따른 유기 발광 소자는, 상기 유기물층 중 1층 이상이 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는 것을 제외하고는 당
30 기술분야에 알려져 있는 재료와 방법으로 제조될 수 있다. 또한, 상기 유기

발광 소자가 복수개의 유기물층을 포함하는 경우, 상기 유기물층은 동일한 물질 또는 다른 물질로 형성될 수 있다.

예컨대, 본 발명에 따른 유기 발광 소자는 기판 상에 제1 전극, 5 유기물층 및 제2 전극을 순차적으로 적층시켜 제조할 수 있다. 이때, 스퍼터링법(sputtering)이나 전자빔 증발법(e-beam evaporation)과 같은 PVD(physical Vapor Deposition)방법을 이용하여, 기판 상에 금속 또는 전도성을 가지는 금속 산화물 또는 이들의 합금을 증착시켜 양극을 형성하고, 그 위에 정공 주입층, 정공 수송층, 발광층 및 전자수송층을 10 포함하는 유기물층을 형성한 후, 그 위에 음극으로 사용할 수 있는 물질을 증착시켜 제조할 수 있다. 이와 같은 방법 외에도, 기판 상에 음극 물질부터 유기물층, 양극 물질을 차례로 증착시켜 유기 발광 소자를 만들 수 있다.

15 또한, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 유기 발광 소자의 제조시 진공 증착법 뿐만 아니라 용액 도포법에 의하여 유기물층으로 형성될 수 있다. 여기서, 용액 도포법이라 함은 스핀 코팅, 딥코팅, 닥터 블레이딩, 잉크젯 프린팅, 스크린 프린팅, 스프레이법, 롤 코팅 등을 의미하지만, 이들만으로 한정되는 것은 아니다.

20

이와 같은 방법 외에도, 기판 상에 음극 물질로부터 유기물층, 양극 물질을 차례로 증착시켜 유기 발광 소자를 제조할 수 있다(WO 2003/012890). 다만, 제조 방법이 이에 한정되는 것은 아니다.

25 일례로, 상기 제1 전극은 양극이고, 상기 제2 전극은 음극이거나, 또는 상기 제1 전극은 음극이고, 상기 제2 전극은 양극이다.

상기 양극 물질로는 통상 유기물층으로 정공 주입이 원활할 수 있도록 일함수가 큰 물질이 바람직하다. 상기 양극 물질의 구체적인 예로는 30 바나듐, 크롬, 구리, 아연, 금과 같은 금속 또는 이들의 합금; 아연 산화물,

인듐 산화물, 인듐주석 산화물(ITO), 인듐아연 산화물(IZO)과 같은 금속 산화물; ZnO:Al 또는 SnO₂:Sb와 같은 금속과 산화물의 조합; 폴리(3-메틸티오펜), 폴리[3,4-(에틸렌-1,2-디옥시)티오펜](PEDOT), 폴리피롤 및 폴리아닐린과 같은 전도성 고분자 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은
5 아니다.

상기 음극 물질로는 통상 유기물층으로 전자 주입이 용이하도록 일함수가 작은 물질인 것이 바람직하다. 상기 음극 물질의 구체적인 예로는 마그네슘, 칼슘, 나트륨, 칼륨, 티타늄, 인듐, 이트륨, 리튬, 가돌리늄,
10 알루미늄, 은, 주석 및 납과 같은 금속 또는 이들의 합금; LiF/Al 또는 LiO₂/Al과 같은 다층 구조 물질 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.

상기 정공주입층은 전극으로부터 정공을 주입하는 층으로, 정공 주입
15 물질로는 정공을 수송하는 능력을 가져 양극에서의 정공 주입효과, 발광층 또는 발광재료에 대하여 우수한 정공 주입 효과를 갖고, 발광층에서 생성된 여기자의 전자주입층 또는 전자주입재료에의 이동을 방지하며, 또한, 박막 형성 능력이 우수한 화합물이 바람직하다. 정공 주입 물질의 HOMO(highest occupied molecular orbital)가 양극 물질의 일함수와 주변 유기물층의
20 HOMO 사이인 것이 바람직하다. 정공 주입 물질의 구체적인 예로는 금속 포피린(porphyrin), 올리고티오펜, 아릴아민 계열의 유기물, 헥사니트릴헥사아자트리페닐렌 계열의 유기물, 퀴나크리돈(quinacridone)계열의 유기물, 페릴렌(perylene) 계열의 유기물, 안트라퀴논 및 폴리아닐린과 폴리티오펜 계열의 전도성 고분자 등이 있으나,
25 이들에만 한정 되는 것은 아니다.

상기 정공수송층은 정공주입층으로부터 정공을 수취하여 발광층까지 정공을 수송하는 층으로, 정공 수송 물질로는 양극이나 정공 주입층으로부터 정공을 수송받아 발광층으로 옮겨줄 수 있는 물질로 정공에
30 대한 이동성이 큰 물질이 적합하다. 구체적인 예로는 아릴아민 계열의

유기물, 전도성 고분자, 및 공액 부분과 비공액 부분이 함께 있는 블록 공중합체 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.

- 상기 전자저지층은 상기 정공수송층 상에 형성되어, 바람직하게는
- 5 발광층에 접하여 구비되어, 정공이동도를 조절하고, 전자의 과도한 이동을 방지하여 정공-전자간 결합 확률을 높여줌으로써 유기 발광 소자의 효율을 개선하는 역할을 하는 층을 의미한다. 상기 전자저지층은 전자저지물질들을 포함하고, 이러한 전자저지물질의 예로 아릴아민 계열의 유기물 등을 사용할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

10

- 상기 발광 물질로는 정공 수송층과 전자 수송층으로부터 정공과 전자를 각각 수송받아 결합시킴으로써 가시광선 영역의 빛을 낼 수 있는 물질로서, 형광이나 인광에 대한 양자 효율이 좋은 물질이 바람직하다. 구체적인 예로 8-히드록시-퀴놀린 알루미늄 착물(Alq_3); 카르바졸 계열
- 15 화합물; 이량체화 스티릴(dimerized styryl) 화합물; $BAIq$; 10-히드록시벤조 퀴놀린-금속 화합물; 벤조사졸, 벤즈티아졸 및 벤즈이미다졸 계열의 화합물; 폴리(p-페닐렌비닐렌)(PPV) 계열의 고분자; 스피로(spiro) 화합물; 폴리플루오렌, 루브렌 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.

20

- 상기 발광층은 상술한 바와 같이 호스트 재료 및 도펀트 재료를 포함할 수 있다. 호스트 재료는 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함할 수 있다. 또는 상기 발광층은 2종 이상의 호스트를 포함하고, 이때 상기 호스트 중 하나가 상기 화학식 1로 표시되는 화합물이고, 다른 호스트
- 25 물질로는 축합 방향족환 유도체 또는 헤테로환 함유 화합물 등이 사용될 수 있다. 구체적으로 축합 방향족환 유도체로는 안트라센 유도체, 피렌 유도체, 나프탈렌 유도체, 펜타센 유도체, 페난트렌 화합물, 플루오란텐 화합물 등이 있고, 헤테로환 함유 화합물로는 카바졸 유도체, 디벤조퓨란 유도체, 래더형 퓨란 화합물, 피리미딘 유도체 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.
- 30 예를 들어, 상기 발광층은 2종의 호스트를 포함하고, 상기 2종의 호스트는

각각 상기 화학식 1로 표시되는 화합물과 비스카바졸 유도체일 수 있다.

도펀트 재료로는 방향족 아민 유도체, 스티릴아민 화합물, 붕소 착체, 플루오란텐 화합물, 금속 착체 등이 있다. 구체적으로 방향족 아민
 5 유도체로는 치환 또는 비치환된 아릴아미노기를 갖는 축합 방향족환 유도체로서, 아릴아미노기를 갖는 피렌, 안트라센, 크리센, 페리플란텐 등이 있으며, 스티릴아민 화합물로는 치환 또는 비치환된 아릴아민에 적어도 1개의 아릴비닐기가 치환되어 있는 화합물로, 아릴기, 실릴기, 알킬기, 사이클로알킬기 및 아릴아미노기로 이루어진 군에서 1 또는 2 이상
 10 선택되는 치환기가 치환 또는 비치환된다. 구체적으로 스티릴아민, 스티릴디아민, 스티릴트리아민, 스티릴테트라아민 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다. 또한, 금속 착체로는 이리듐 착체, 백금 착체 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.

15 상기 전자수송층은 전자주입층으로부터 전자를 수취하여 발광층까지 전자를 수송하는 층으로, 전자 수송 물질로는 음극으로부터 전자를 잘 주입 받아 발광층으로 옮겨줄 수 있는 물질로서, 전자에 대한 이동성이 큰 물질이 적합하다. 구체적인 예로는 8-히드록시퀴놀린의 Al 착물; Alq₃를 포함한 착물; 유기 라디칼 화합물; 히드록시플라본-금속 착물 등이 있으나,
 20 이들에만 한정되는 것은 아니다. 전자 수송층은 종래기술에 따라 사용된 바와 같이 임의의 원하는 캐소드 물질과 함께 사용할 수 있다. 특히, 적절한 캐소드 물질의 예는 낮은 일함수를 가지고 알루미늄층 또는 실버층이 뒤따르는 통상적인 물질이다. 구체적으로 세슘, 바륨, 칼슘, 이테르븀 및 사마륨이고, 각 경우 알루미늄 층 또는 실버층이 뒤따른다.

25

상기 전자주입층은 전극으로부터 전자를 주입하는 층으로, 전자를 수송하는 능력을 갖고, 음극으로부터의 전자 주입 효과, 발광층 또는 발광 재료에 대하여 우수한 전자주입 효과를 가지며, 발광층에서 생성된 여기자의 정공주입층에의 이동을 방지하고, 또한, 박막형성능력이 우수한
 30 화합물이 바람직하다. 구체적으로는 플루오레논, 안트라퀴노다이에탄,

다이페노키논, 티오피란 다이옥사이드, 옥사졸, 옥사다이하졸, 트리아졸, 이미다졸, 페릴렌테트라카복실산, 프레오레닐리덴 메탄, 안트론 등과 그들의 유도체, 금속 착체 화합물 및 질소 함유 5원환 유도체 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.

5

상기 금속 착체 화합물로서는 8-하이드록시퀴놀리나토 리튬, 비스(8-하이드록시퀴놀리나토)아연, 비스(8-하이드록시퀴놀리나토)구리, 비스(8-하이드록시퀴놀리나토)망간, 트리스(8-하이드록시퀴놀리나토)알루미늄, 트리스(2-메틸-8-하이드록시퀴놀리나토)알루미늄, 트리스(8-하이드록시퀴놀리나토)갈륨, 비스(10-하이드록시벤조[h]퀴놀리나토)베릴륨, 비스(10-하이드록시벤조[h]퀴놀리나토)아연, 비스(2-메틸-8-퀴놀리나토)클로로갈륨, 비스(2-메틸-8-퀴놀리나토)(o-크레졸라토)갈륨, 비스(2-메틸-8-퀴놀리나토)(1-나프톨라토)알루미늄, 비스(2-메틸-8-퀴놀리나토)(2-나프톨라토)갈륨 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.

15

본 발명에 따른 유기 발광 소자는 사용되는 재료에 따라 전면 발광형, 후면 발광형 또는 양면 발광형일 수 있다.

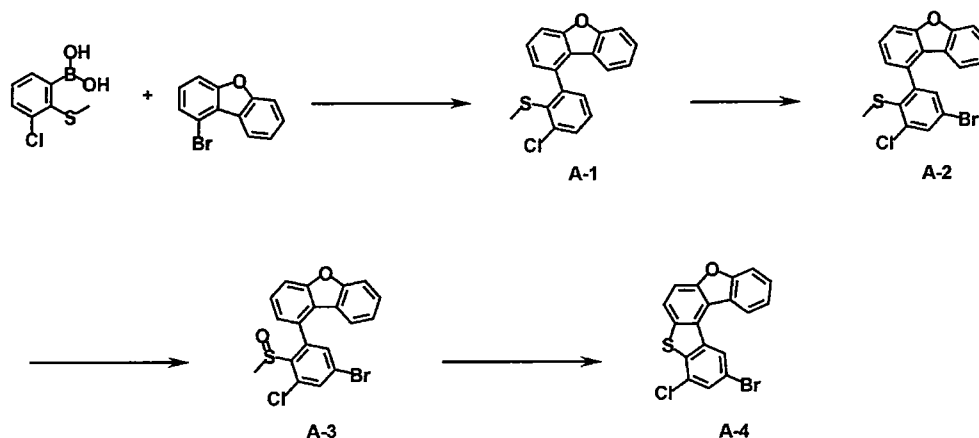
또한, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 유기 발광 소자 외에도 유기 태양 전지 또는 유기 트랜지스터에 포함될 수 있다.

20

상기 화학식 1로 표시되는 화합물 및 이를 포함하는 유기 발광 소자의 제조는 이하 실시예에서 구체적으로 설명한다. 그러나 하기 실시예는 본 발명을 예시하기 위한 것이며, 본 발명의 범위가 이들에 의하여 한정되는 것은 아니다.

25

제조예 A: 중간체 화합물 A-4의 제조



1) 화합물 A-1의 제조

질소 분위기에서 (3-클로로-2-(메틸티오)페닐)보론산(50.0 g, 247.5 mmol)와 4-브로모디벤조[b,d]퓨란(60.9 g, 247.5 mmol)을 테트라하이드로퓨란 400 ml에 넣고 교반 및 환류하였다. 이후 포타슘카보네이트(102.6 g, 742.5 mmol)를 물 200 ml에 녹여 투입하고 충분히 교반한 후 테트라키스트리페닐-포스피노팔라듐(8.6 g, 3 mol%)을 투입하였다. 12시간 반응 후 상온으로 온도를 낮추고 유기층과 물층을 분리한 후 유기층을 감압 증류하였다. 증류물을 클로로포름과 물로 추출한 후 유기층을 황산마그네슘을 이용해 건조하였다. 이후 유기층을 건조한 후 에탄올 재결정을 통해 화합물 A-1(43.3 g, 54%)을 제조하였다.

MS: $[M+H]^+ = 325$

2) 화합물 A-2의 제조

질소 분위기에서 화합물 A-1(43.3 g, 133.6 mmol)을 클로로포름 500 ml에 녹여 투입하고 0℃에서 충분히 교반한 후 브로민(25.3g, 160.4 mmol)를 천천히 적가하였다. 서서히 상온으로 승온한 후 8시간 반응 후 물을 투입하여 반응을 종결하였다. 이후 물과 싸이오황산 나트륨 용액을 이용하여 각각 3회 추출한 후 유기층을 감압 증류하였다. 증류물을 클로로포름과 물로 추출한 후 유기층을 황산마그네슘을 이용해 건조하였다. 이후 유기층을 건조한 후 에탄올 재결정을 통해 화합물 A-2(41.4 g, 77%))를 제조하였다.

MS: $[M+H]^+ = 403$

3) 화합물 A-3의 제조

질소 분위기에서 화합물 A-2(41.4 g, 103.0 mmol)을 초산 400 ml에
 녹여 투입하고 실온에서 충분히 교반한 후 과산화수소(11.7g, 103.0
 5 mmol)를 천천히 적가하였다. 서서히 상온으로 승온한 후 24시간 반응 후
 물을 투입하여 반응을 종결하였다. 이후 물과 클로로포름을 이용하여 3회
 추출한 후 유기층을 감압 증류하였다. 증류물을 클로로포름과 물로 추출한
 후 유기층을 황산마그네슘을 이용해 건조하였다. 이후 유기층을 건조한 후
 감압증류기를 통해 완전히 증류 하여 화합물 A-3(43.0 g, 100%)을
 10 제조하였다

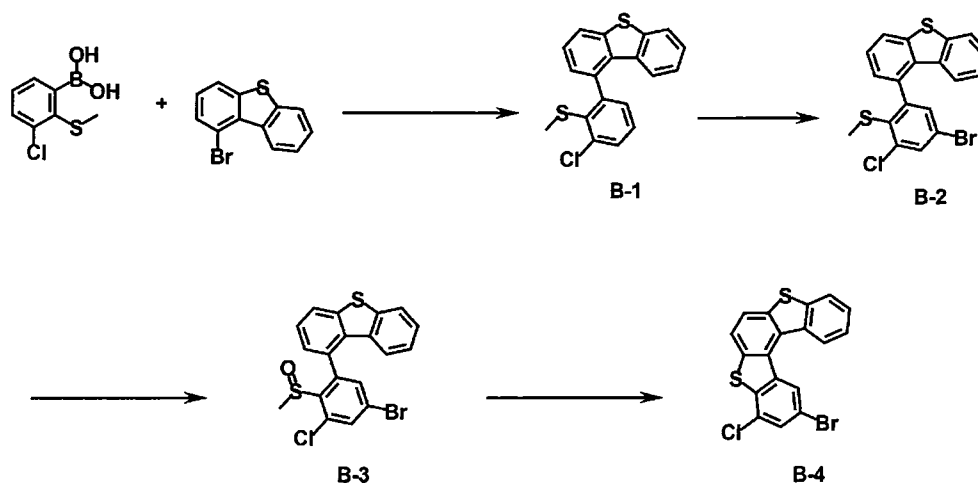
MS: $[M+H]^+ = 419$

4) 화합물 A-4의 제조

질소 분위기에서 화합물 A-3(43.0 g, 103.0 mmol)을
 15 디메틸포름아마이드 300 ml에 넣고 교반하였다. 이후
 포타슘카보네이트(94.9 g, 206.0 mmol)를 투입한 후 환류하였다. 2시간 후
 상온으로 온도를 낮추고 여과하였다. 여과물을 클로로포름과 물로 추출한
 후 유기층을 황산마그네슘을 이용해 건조하였다. 이후 유기층을 감압증류
 후 에틸 아세테이트를 이용해 재결정하였다. 생성된 고체를 여과 후
 20 건조하여 화합물 A-4(20.7 g, 52%)를 제조하였다

MS: $[M+H]^+ = 387$

제조예 B: 중간체 화합물 B-4의 제조



1) 화합물 B-1의 제조

질소 분위기에서 (3-클로로-2-(메틸티오)페닐)보론산(50.0 g, 247.5mmol)와 1-브로모디벤조[b,d]티오펜(64.8 g, 247.5 mmol)을 테트라하이드로퓨란 400 ml에 넣고 교반 및 환류하였다. 이 후 포타슘카보네이트(102.6 g, 742.5 mmol)를 물 200 ml에 녹여 투입하고 충분히 교반한 후 테트라키스트리페닐-포스피노팔라듐(8.6 g, 3 mol%)을 투입하였다. 12시간 반응 후 상온으로 온도를 낮추고 유기층과 물층을 분리한 후 유기층을 감압 증류하였다. 증류물을 클로로포름과 물로 추출한 후 유기층을 황산마그네슘을 이용해 건조하였다. 이후 유기층을 건조한 후 에탄올 재결정을 통해 화합물 B-1(52.2 g, 62%)을 제조하였다.

MS: $[M+H]^+ = 341$

2) 화합물 B-2의 제조

질소 분위기에서 화합물 B-1(52.2 g, 153.5 mmol)을 클로로포름 500ml에 녹여 투입하고 0℃에서 충분히 교반한 후 브로민(29.1g, 184.2 mmol)을 천천히 적가하였다. 서서히 상온으로 승온한 후 8시간 반응 후 물을 투입하여 반응을 종결하였다. 이후 물과 싸이오황산 나트륨 용액을 이용하여 각각 3회 추출한 후 유기층을 감압 증류하였다. 증류물을 클로로포름과 물로 추출한 후 유기층을 황산마그네슘을 이용해 건조하였다. 이후 유기층을 건조한 후 에탄올 재결정을 통해 화합물 B-2(44.3 g, 69%)를 제조하였다.

MS: $[M+H]^+ = 419$

3) 화합물 B-3의 제조

질소 분위기에서 화합물 B-2(44.3 g, 106.0 mmol)를 초산 500 ml에
 5 녹여 투입하고 실온에서 충분히 교반한 후 과산화수소(12.0g, 106.0
 mmol)를 천천히 적가하였다. 서서히 상온으로 승온한 후 24시간 반응 후
 물을 투입하여 반응을 종결하였다. 이후 물과 클로로포름을 이용하여 3회
 추출한 후 유기층을 감압 증류하였다. 증류물을 클로로포름과 물로 추출한
 후 유기층을 황산마그네슘을 이용해 건조하였다. 이후 유기층을 건조한 후
 10 감압증류기를 통해 완전히 증류 하여 화합물 B-3(46.0 g, 100%)을
 제조하였다

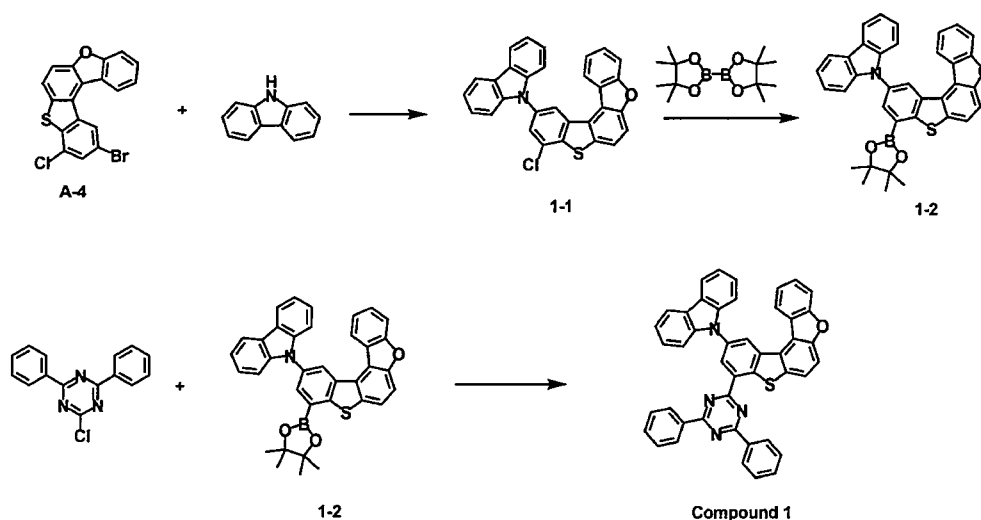
MS: $[M+H]^+ = 435$

4) 화합물 B-4의 제조

15 질소 분위기에서 화합물 B-3(46.0 g, 106.0 mmol)을
 디메틸포름아마이드 300 ml에 넣고 교반하였다. 이후
 포타슘카보네이트(97.7 g, 212.0 mmol)를 투입한 후 환류하였다. 2시간 후
 상온으로 온도를 낮추고 여과하였다. 여과물을 클로로포름과 물로 추출한
 후 유기층을 황산마그네슘을 이용해 건조하였다. 이후 유기층을 감압증류
 20 후 에틸 아세테이트를 이용해 재결정하였다. 생성된 고체를 여과 후
 건조하여 화합물 B-4(22.2 g, 52%)을 제조하였다

MS: $[M+H]^+ = 403$

제조예 1: 화합물 1의 제조



1) 화합물 1-1의 제조

상기 제조예 A에서 제조한 화합물 A-4(20.0 g, 51.8 mmol)와 9H-카바졸 (10.4 g, 62.2 mmol)을 자일렌 100 ml에 투입하여 녹이고, 나트륨 tert-부톡사이드 (14.3g, 103.7 mmol)를 첨가하여 가온하였다. 비스(트리 tert-부틸포스핀)팔라듐(0.8g, 3mol%)을 투입하여 12시간 환류 교반시켰다. 반응이 완결되면 상온으로 온도를 낮춘 후 생성된 고체를 여과하였다. 고체를 클로로포름 700 mL에 녹이고, 물로 2회 세척 후에 유기층을 5 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 클로로포름과 에틸아세테이트를 이용하여 실리카 컬럼을 통해 정제하여 얻은 얻은 녹색의 고체 화합물 1-1(16.7 g, 68%)을 제조하였다.

MS: $[M+H]^+ = 474$

2) 화합물 1-2의 제조

질소 분위기에서 화합물 1-1(16.7 g, 35.3 mmol), 비스(피나콜라토)다이보론(9.9 g, 38.8 mmol) 및 아세트산칼륨(6.9 g, 70.6 mmol)을 섞고, 디옥산 200 ml에 첨가하고 교반하면서 가열하였다. 환류되는 20 상태에서 비스(디벤질리딘아세톤)팔라듐(0.6 g, 1.1 mmol)과 트리사이클로헥실포스핀(.6 g, 2.2 mmol)을 넣고 3시간 동안 가열, 교반하였다. 반응 종료 후, 상온으로 온도를 낮춘 후 여과하였다. 여과액에

물을 붓고 클로로포름으로 추출하고, 유기층을 무수황산마그네슘으로 건조하였다. 감압 증류 후 에탄올로 재결정하여 화합물 1-2(15.2g, 76%)를 제조하였다

MS: $[M+H]^+ = 566$

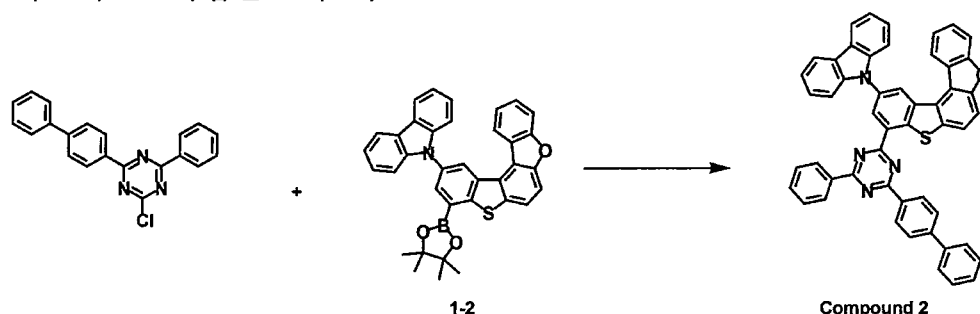
5

3) 화합물 1의 제조

질소 분위기에서 화합물 1-2(15.2 g, 26.9 mmol)와 2-클로로-4,6-디페닐-1,3,5-트리아진(7.2 g, 26.9 mmol)를 테트라하이드로퓨란 200 ml에 넣고 교반 및 환류하였다. 이 후 포타슘카보네이트(11.2 g, 80.7 mmol)를 물 30 ml에 녹여 투입하고 충분히 교반한 후 테트라키스트리페닐-포스피노팔라듐(0.9 g, 3 mol%)을 투입하였다. 4시간 반응 후 상온으로 온도를 낮춘 후 여과하였다. 여과물을 클로로포름에 녹인 후 물로 추출한 후 유기층을 황산마그네슘을 이용해 건조하였다. 이후 유기층을 건조한 후 에틸아세테이트 재결정을 통해 화합물 1(9.2 g, 51%)을 제조하였다.

15 MS: $[M+H]^+ = 671$

제조예 2: 화합물 2의 제조



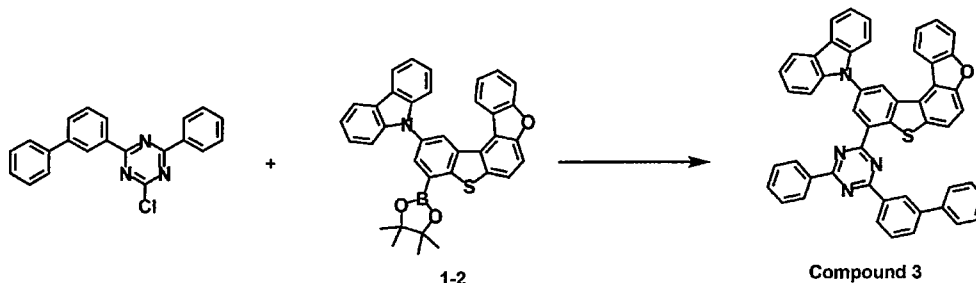
20 질소 분위기에서 상기 제조예 1에서 제조한 화합물 1-2(15.2 g, 26.9 mmol)와 2-([1,1'-비페닐]-4-일)-4-클로로-6-페닐-1,3,5-트리아진(9.2 g, 26.9 mmol)을 테트라하이드로퓨란 200 ml에 넣고 교반 및 환류하였다. 이후 포타슘카보네이트(11.2 g, 80.7 mmol)를 물 30 ml에 녹여 투입하고 충분히 교반한 후 테트라키스트리페닐-포스피노팔라듐(0.9 g, 3 mol%)을 투입하였다. 4시간 반응 후 상온으로 온도를 낮춘 후 여과하였다. 여과물을 클로로포름에 녹인 후 물로 추출한 후 유기층을 황산마그네슘을 이용해

25

건조하였다. 이후 유기층을 건조한 후 에틸아세테이트 재결정을 통해 화합물 2(11.4 g, 63%)을 제조하였다.

MS: $[M+H]^+ = 747$

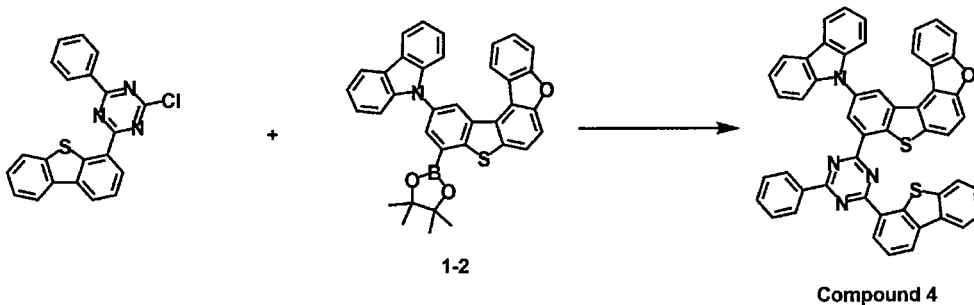
5 제조예 3: 화합물 3의 제조



질소 분위기에서 상기 제조예 1에서 제조한 화합물 1-2(15.2 g, 26.9 mmol)와 2-([1,1'-비페닐]-3-일)-4-클로로-6-페닐-1,3,5-트리아진(9.2 g, 26.9 mmol)을 테트라하이드로퓨란 200 ml에 넣고 교반 및 환류하였다. 이후 10 포타슘카보네이트(11.2 g, 80.7 mmol)를 물 30 ml에 녹여 투입하고 충분히 교반한 후 테트라키스트리페닐-포스피노팔라듐(0.9 g, 3 mol%)을 투입하였다. 4시간 반응 후 상온으로 온도를 낮춘 후 여과하였다. 여과물을 클로로포름에 녹인 후 물로 추출한 후 유기층을 황산마그네슘을 이용해 15 건조하였다. 이후 유기층을 건조한 후 에틸아세테이트 재결정을 통해 화합물 3(9.4 g, 52%)을 제조하였다.

MS: $[M+H]^+ = 747$

제조예 4: 화합물 4의 제조



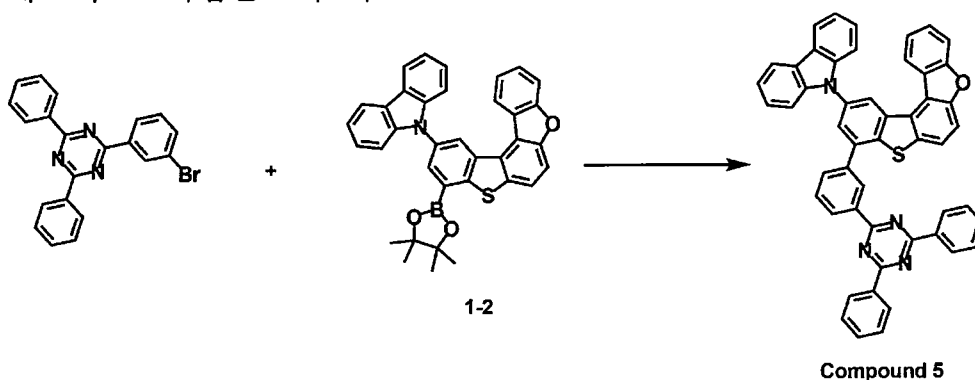
질소 분위기에서 상기 제조예 1에서 제조한 화합물 1-2(15.2 g, 26.9

mmol)와 2-클로로-4-(디벤조[b,d]티오펜-4-일)-6-페닐-1,3,5-트리아진(10.0 g, 26.9 mmol)을 테트라하이드로퓨란 200 ml에 넣고 교반 및 환류하였다. 이후 포타슘카보네이트(11.2 g, 80.7 mmol)를 물 30 ml에 녹여 투입하고 충분히 교반한 후 테트라키스트리페닐-포스피노팔라듐(0.9 g, 3 mol%)을 투입하였다. 4시간 반응 후 상온으로 온도를 낮춘 후 여과하였다. 여과물을 클로로포름에 녹인 후 물로 추출한 후 유기층을 황산마그네슘을 이용해 건조하였다. 이후 유기층을 건조한 후 에틸아세테이트 재결정을 통해 화합물 4(16.5 g, 79%)을 제조하였다.

MS: $[M+H]^+ = 777$

10

제조예 5: 화합물 5의 제조

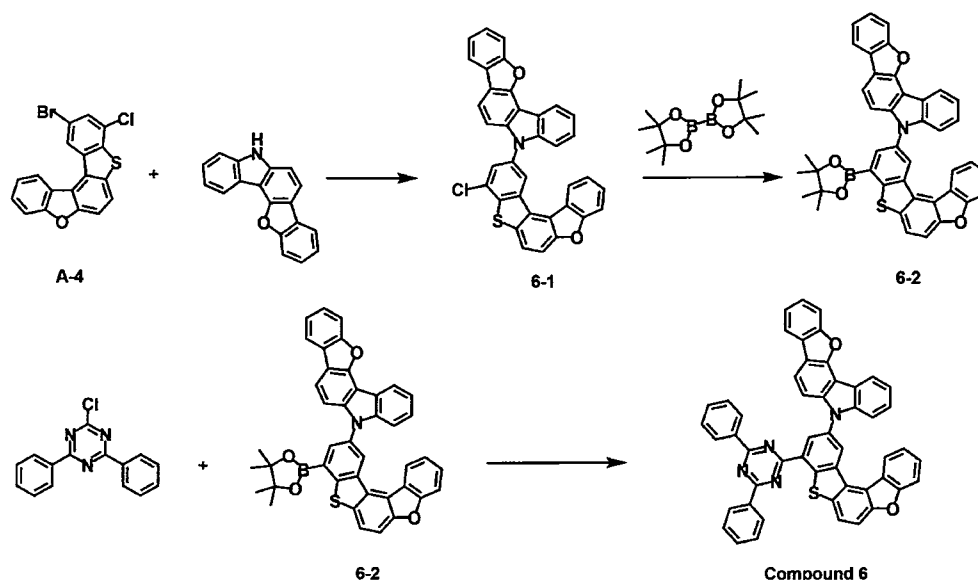


질소 분위기에서 상기 제조예 1에서 제조한 화합물 1-2(15.2 g, 26.9 mmol)와 2-(3-브로모페닐)-4,6-디페닐-1,3,5-트리아진(10.0 g, 26.9 mmol)를 테트라하이드로퓨란 200 ml에 넣고 교반 및 환류하였다. 이후 포타슘카보네이트(11.2 g, 80.7 mmol)를 물 30 ml에 녹여 투입하고 충분히 교반한 후 테트라키스트리페닐-포스피노팔라듐(0.9 g, 3 mol%)을 투입하였다. 4시간 반응 후 상온으로 온도를 낮춘 후 여과하였다. 여과물을 클로로포름에 녹인 후 물로 추출한 후 유기층을 황산마그네슘을 이용해 건조하였다. 이후 유기층을 건조한 후 에틸아세테이트 재결정을 통해 화합물 5(6.2 g, 31%)를 제조하였다.

MS: $[M+H]^+ = 747$

25

제조예 6: 화합물 6의 제조



1) 화합물 6-1의 제조

상기 제조예 A에서 제조한 화합물 A-4(20.0 g, 51.8 mmol)와 5H-벤조퓨로[3,2-c]카바졸(16.0 g, 62.2 mmol)을 자일렌 100 ml에 투입하여 녹이고, 나트륨 tert-부톡사이드 (14.3g, 103.7 mmol)를 첨가하여 가온하였다. 비스(트리 tert-부틸포스핀)팔라듐(0.8g, 3mol%)을 투입하여 12시간 환류 교반시켰다. 반응이 완결되면 상온으로 온도를 낮춘 후 생성된 고체를 여과하였다. 고체를 클로로포름 700 mL에 녹이고, 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 클로로포름과 에틸아세테이트를 이용하여 실리카 컬럼을 통해 정제하여 얻은 얻은 녹색의 고체 화합물 6-1(21.9 g, 75%)을 제조하였다.

MS: $[M+H]^+ = 564$

2) 화합물 6-2의 제조

질소 분위기에서 화합물 6-1(21.9 g, 38.9 mmol), 비스(피나콜라토)다이보론(10.9g, 42.8mmol) 및 아세트산칼륨(7.6 g, 77.8 mmol)을 섞고, 디옥산 200 ml에 첨가하고 교반하면서 가열하였다. 환류되는 상태에서 비스(디벤질리딘아세톤)팔라듐(0.7 g, 1.2 mmol)과 트리사이클로헥실포스핀(0.7 g, 2.4 mmol)을 넣고 3시간 동안 가열,

교반하였다. 반응 종료 후, 상온으로 온도를 낮춘 후 여과하였다. 여과액에 물을 붓고 클로로포름으로 추출하고, 유기층을 무수황산마그네슘으로 건조하였다. 감압 증류 후 에탄올로 재결정하여 화합물 6-2(20.6g, 81%)를 제조하였다.

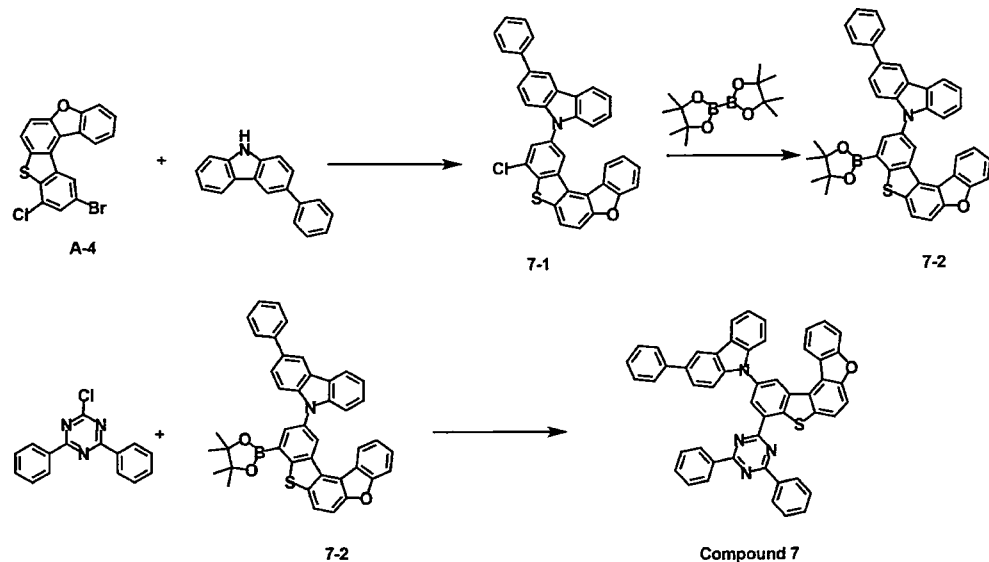
5 MS: $[M+H]^+ = 656$

3) 화합물 6의 제조

질소 분위기에서 화합물 6-2(20.6 g, 36.5 mmol)와 2-클로로-4,6-디페닐-1,3,5-트리아진(9.7 g, 36.5 mmol)을 테트라하이드로퓨란 200 ml에
10 넣고 교반 및 환류하였다. 이후 포타슘카보네이트(15.1 g, 109.3 mmol)를 물 30 ml에 녹여 투입하고 충분히 교반한 후 테트라키스트리페닐-포스피노팔라듐(1.3 g, 3 mol%)을 투입하였다. 4시간 반응 후 상온으로 온도를 낮춘 후 여과하였다. 여과물을 클로로포름에 녹인 후 물로 추출한 후 유기층을 황산마그네슘을 이용해 건조하였다. 이후 유기층을 건조한 후
15 에틸아세테이트 재결정을 통해 화합물 6(17.5 g, 63%)을 제조하였다.

MS: $[M+H]^+ = 761$

제조예 7: 화합물 7의 제조



20

1) 화합물 7-1의 제조

상기 제조예 A에서 제조한 화합물 A-4 (20.0 g, 51.8 mmol)과 3-페닐-9H-카바졸(15.1 g, 62.2 mmol)을 자일렌 100 ml에 투입하여 녹이고, 나트륨 tert-부톡사이드(14.3g, 103.7 mmol)를 첨가하여 가온하였다. 비스(트리 tert-부틸포스핀)팔라듐(0.8g, 3mol%)을 투입하여 12시간 환류 교반시켰다. 반응이 완결되면 상온으로 온도를 낮춘 후 생성된 고체를 여과하였다. 고체를 클로로포름 700mL에 녹이고, 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 클로로포름과 에틸아세테이트을 이용하여 실리카 컬럼을 통해 정제하여 얻은 얻은 녹색의 고체 화합물 7-1(19.6 g, 69%)을 제조하였다.

MS: $[M+H]^+ = 550$

2) 화합물 7-2의 제조

질소 분위기에서 화합물 7-1(19.6 g, 35.7 mmol), 비스(피나콜라토)다이보론(10.0g, 39.3mmol) 및 아세트산칼륨(67.0 g, 71.4 mmol)을 섞고, 디옥산 200 ml에 첨가하고 교반하면서 가열하였다. 환류되는 상태에서 비스(디벤질리딘아세톤)팔라듐(0.6 g, 1.01 mmol)과 트리사이클로헥실포스핀(0.6 g, 2.2 mmol)을 넣고 3시간 동안 가열, 교반하였다. 반응 종료 후, 상온으로 온도를 낮춘 후 여과하였다. 여과액에 물을 붓고 클로로포름으로 추출하고, 유기층을 무수황산마그네슘으로 건조하였다. 감압 증류 후 에탄올로 재결정하여 화합물 6-2(16.9g, 81%)를 제조하였다

MS: $[M+H]^+ = 642$

3) 화합물 7의 제조

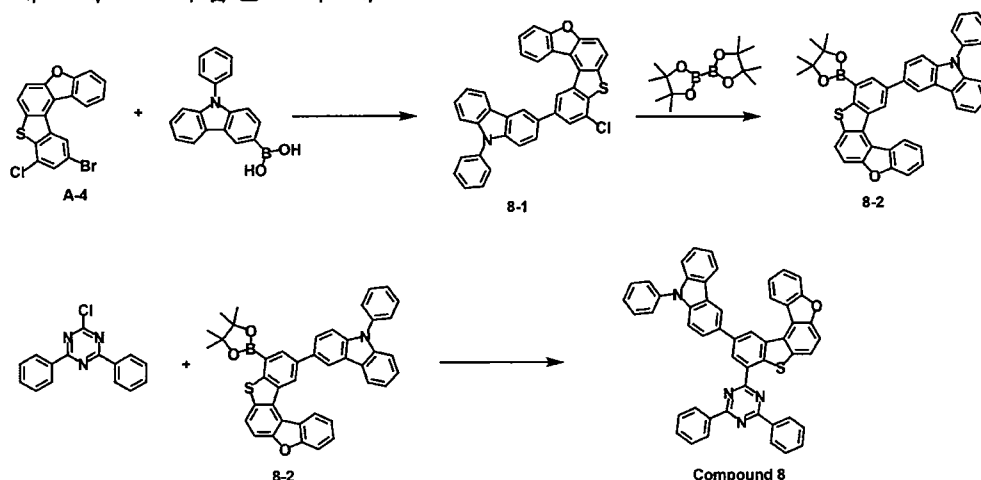
질소 분위기에서 화합물 6-2(16.9 g, 26.4 mmol)와 2-클로로-4,6-디페닐-1,3,5-트리아진(8.4 g, 31.6 mmol)를 테트라하이드로퓨란 200 ml에 넣고 교반 및 환류하였다. 이후 포타슘카보네이트(10.9 g, 79.1 mmol)를 물 30 ml에 녹여 투입하고 충분히 교반한 후 테트라키스트리페닐-포스피노팔라듐(0.9 g, 3 mol%)을 투입하였다. 4시간 반응 후 상온으로

온도를 낮춘 후 여과하였다. 여과물을 클로로포름에 녹인 후 물로 추출한 후 유기층을 황산마그네슘을 이용해 건조하였다. 이후 유기층을 건조한 후 에틸아세테이트 재결정을 통해 화합물 7(8.9 g, 45%)을 제조하였다.

MS: $[M+H]^+ = 747$

5

제조예 8: 화합물 8의 제조



1) 화합물 8-1의 제조

- 10 상기 제조예 A에서 제조한 화합물 A-4 (20.0 g, 51.8 mmol)과 (9-페닐-9H-카바졸-3-일)보론산 (16.4 g, 62.2 mmol)을 테트라하이드로퓨란 200mL에 투입하여 녹이고, 포타슘카보네이트 (21.5g, 103.7 mmol)를 물에 녹여 첨가하여 가온하였다. 테트라키스트리페닐-포스피노팔라듐(1.8 g, 3 mol%)을 투입하여 12시간 환류 교반시켰다. 반응이 완결되면 상온으로
- 15 온도를 낮춘 후 생성된 고체를 여과하였다. 고체를 클로로포름 700mL에 녹이고, 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 클로로포름과 에틸아세테이트를 이용하여 실리카 컬럼을 통해 정제하여
- 열은 열은 녹색의 고체 화합물 8-1(19.6 g, 69%)을 제조하였다.

20 MS: $[M+H]^+ = 550$

2) 화합물 8-2의 제조

질소 분위기에서 화합물 8-1(19.6 g, 39.3

mmol), 비스(피나콜라토)다이보론(11.0 g, 43.3mmol) 및 아세트산칼륨(7.7 g, 78.7 mmol)을 섞고, 디옥산 200 ml에 첨가하고 교반하면서 가열하였다. 환류되는 상태에서 비스(디벤질리딘아세톤)팔라듐(0.7 g, 1.2 mmol)과 트리사이클로헥실포스핀(0.7 g, 2.4 mmol)을 넣고 4시간 동안 가열, 5 교반하였다. 반응 종료 후, 상온으로 온도를 낮춘 후 여과하였다. 여과액에 물을 붓고 클로로포름으로 추출하고, 유기층을 무수황산마그네슘으로 건조하였다. 감압 증류 후 에탄올로 재결정하여 화합물 8-2(16.5g, 72%)를 제조하였다.

MS: $[M+H]^+ = 642$

10

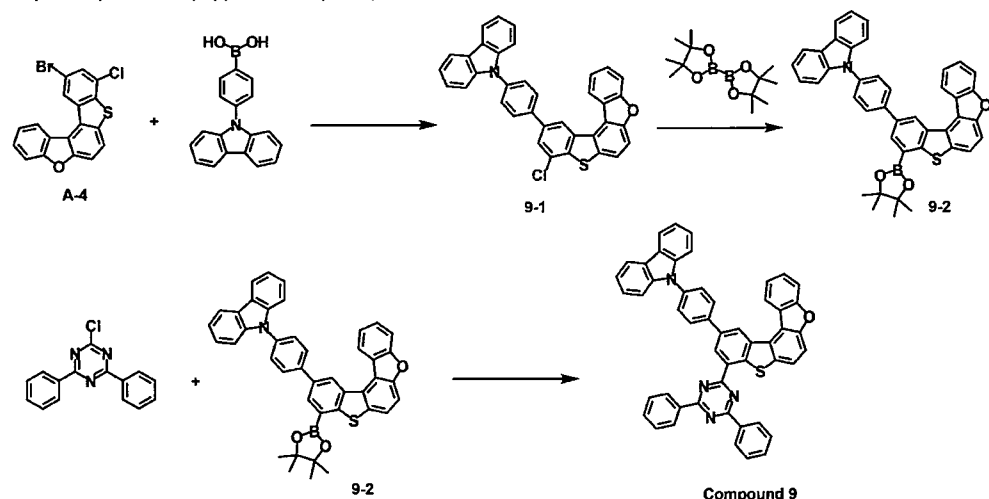
3) 화합물 8의 제조

질소 분위기에서 화합물 8-2 (16.5 g, 25.7 mmol)와 2-클로로-4,6-디페닐-1,3,5-트리아진(6.9 g, 25.7 mmol)를 테트라하이드로퓨란 200 ml에 넣고 교반 및 환류하였다. 이후 포타슘카보네이트(10.7 g, 77.2 mmol)를 15 물 30 ml에 녹여 투입하고 충분히 교반한 후 테트라키스트리페닐-포스피노팔라듐(0.9 g, 3 mol%)을 투입하였다. 4시간 반응 후 상온으로 온도를 낮춘 후 여과하였다. 여과물을 클로로포름에 녹인 후 물로 추출한 후 유기층을 황산마그네슘을 이용해 건조하였다. 이후 유기층을 건조한 후 에틸아세테이트 재결정을 통해 화합물 8(11.7 g, 61%)을 제조하였다.

20

MS: $[M+H]^+ = 747$

제조예 9: 화합물 9의 제조



1) 화합물 9-1의 제조

상기 제조예 A에서 제조한 화합물 A-4(20.0 g, 51.8 mmol)와 (4-(9H-카바졸-9-일)페닐)보론산(16.4 g, 62.2 mmol)을 테트라하이드로퓨란 200 mL에 투입하여 녹이고, 포타슘카보네이트 (21.5g, 103.7 mmol)를 물에 녹여 첨가하여 가온하였다. 테트라키스트리페닐-포스피노팔라듐(1.8 g, 3 mol%)을 투입하여 12시간 환류 교반시켰다. 반응이 완결되면 상온으로 온도를 낮춘 후 생성된 고체를 여과하였다. 고체를 클로로포름 700 mL에 녹이고, 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 클로로포름과 에틸아세테이트를 이용하여 실리카 컬럼을 통해 정제하여 얻은 옅은 녹색의 고체 화합물 9-1(16.5 g, 58%)을 제조하였다.

MS: $[M+H]^+ = 550$

2) 화합물 9-2의 제조

질소 분위기에서 화합물 8-1(16.5 g, 30.1 mmol), 비스(피나콜라토)다이보론(8.4 g, 33.1 mmol) 및 아세트산칼륨(5.9 g, 60.1 mmol)을 섞고, 디옥산 200 ml에 첨가하고 교반하면서 가열하였다. 환류되는 상태에서 비스(디벤질리딘아세톤)팔라듐(0.5 g, 0.9 mmol)과 트리사이클로헥실포스핀(0.5 g, 1.8mmol)을 넣고 4시간 동안 가열, 교반하였다. 반응 종료 후, 상온으로 온도를 낮춘 후 여과하였다. 여과액에 물을 붓고 클로로포름으로 추출하고, 유기층을 무수황산마그네슘으로 건조하였다. 감압 증류 후 에탄올로 재결정하여 화합물 9-2(14.6g, 76%)를 제조하였다.

MS: $[M+H]^+ = 642$

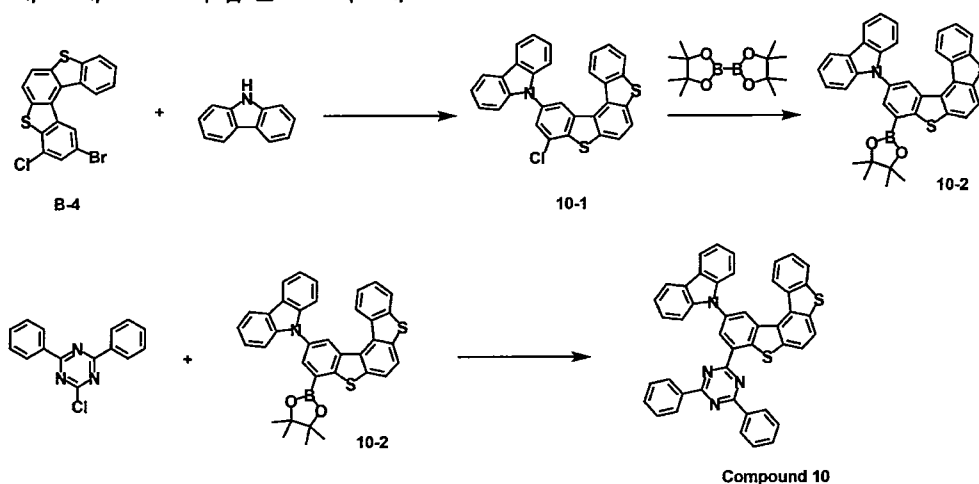
3) 화합물 9의 제조

질소 분위기에서 화합물 9-2 (14.6 g, 22.8 mmol)와 2-클로로-4,6-디페닐-1,3,5-트리아진(6.1 g, 22.8 mmol)를 테트라하이드로퓨란 200 ml에 넣고 교반 및 환류하였다. 이후 포타슘카보네이트(9.4 g, 68.3 mmol)를 물

30 ml에 녹여 투입하고 충분히 교반한 후 테트라키스트리페닐-포스피노팔라듐(0.8 g, 3 mol%)을 투입하였다. 4시간 반응 후 상온으로 온도를 낮춘 후 여과하였다. 여과물을 클로로포름에 녹인 후 물로 추출한 후 유기층을 황산마그네슘을 이용해 건조하였다. 이후 유기층을 건조한 후 5 에틸아세테이트 재결정을 통해 화합물 9(8.5 g, 50%)을 제조하였다.

MS: $[M+H]^+ = 747$

제조예 10: 화합물 10의 제조



10

1) 화합물 10-1의 제조

상기 제조예 B에서 제조한 화합물 B-4 (20.0 g, 49.8 mmol)과 9H-카바졸 (10.0 g, 59.7 mmol)을 자일렌 100 ml에 투입하여 녹이고, 나트륨 tert-부톡사이드 (13.8g, 99.5 mmol)를 첨가하여 가온하였다. 비스(트리 tert-부틸포스핀)팔라듐(0.8g, 3mol%)을 투입하여 12시간 환류 교반시켰다. 15 반응이 완결되면 상온으로 온도를 낮춘 후 생성된 고체를 여과하였다. 고체를 클로로포름 700mL에 녹이고, 물로 2회 세척 후에 유기층을 분리하여, 무수황산마그네슘을 넣고 교반한 후 여과하여 여액을 감압 증류하였다. 농축한 화합물을 클로로포름과 에틸아세테이트를 이용하여 실리카 컬럼을 20 통해 정제하여 얻은 얻은 녹색의 고체 화합물 10-1(16.1 g, 66%)을 제조하였다.

MS: $[M+H]^+ = 490$

2) 화합물 10-2의 제조

질소 분위기에서 화합물 10-1(16.1 g, 32.9 mmol), 비스(피나콜라토)다이보론(9.2g, 36.2mmol) 및 아세트산칼륨(6.5 g, 65.8 mmol)을 섞고, 디옥산 200 ml에 첨가하고 교반하면서 가열하였다. 환류되는 상태에서 비스(디벤질리딘아세톤)팔라듐(0.6 g, 1.0 mmol)과 트리사이클로헥실포스핀(0.6 g, 2.0 mmol)을 넣고 3시간 동안 가열, 교반하였다. 반응 종료 후, 상온으로 온도를 낮춘 후 여과하였다. 여과액에 물을 붓고 클로로포름으로 추출하고, 유기층을 무수황산마그네슘으로 건조하였다. 감압 증류 후 에탄올로 재결정하여 화합물 10-2(13.2g, 69%)를 제조하였다

MS: $[M+H]^+ = 582$

3) 화합물 10의 제조

질소 분위기에서 화합물 10-2 (13.2 g, 22.7 mmol)와 2-클로로-4,6-디페닐-1,3,5-트리아진(6.1 g, 22.7 mmol)를 테트라하이드로퓨란 200 ml에 넣고 교반 및 환류하였다. 이후 포타슘카보네이트(10.3 g, 74.8 mmol)를 물 30 ml에 녹여 투입하고 충분히 교반한 후 테트라키스트리페닐-포스피노팔라듐(0.9 g, 3 mol%)을 투입하였다. 4시간 반응 후 상온으로 온도를 낮춘 후 여과하였다. 여과물을 클로로포름에 녹인 후 물로 추출한 후 유기층을 황산마그네슘을 이용해 건조하였다. 이후 유기층을 건조한 후 에틸아세테이트 재결정을 통해 화합물 10(10.0 g, 64%)을 제조하였다.

MS: $[M+H]^+ = 687$

실시예 1: 유기 발광 소자의 제조

ITO(indium tin oxide)가 1,300Å의 두께로 박막 코팅된 유리 기판을 세제를 녹인 증류수에 넣고 초음파로 세척하였다. 이때, 세제로는 피셔사(Fischer Co.) 제품을 사용하였으며, 증류수로는 밀리포어사(Millipore Co.) 제품의 필터(Filter)로 2차로 걸러진 증류수를 사용하였다. ITO를 30분간 세척한 후 증류수로 2회 반복하여 초음파 세척을 10분간 진행하였다. 증류수 세척이 끝난 후, 이소프로필알콜, 아세톤,

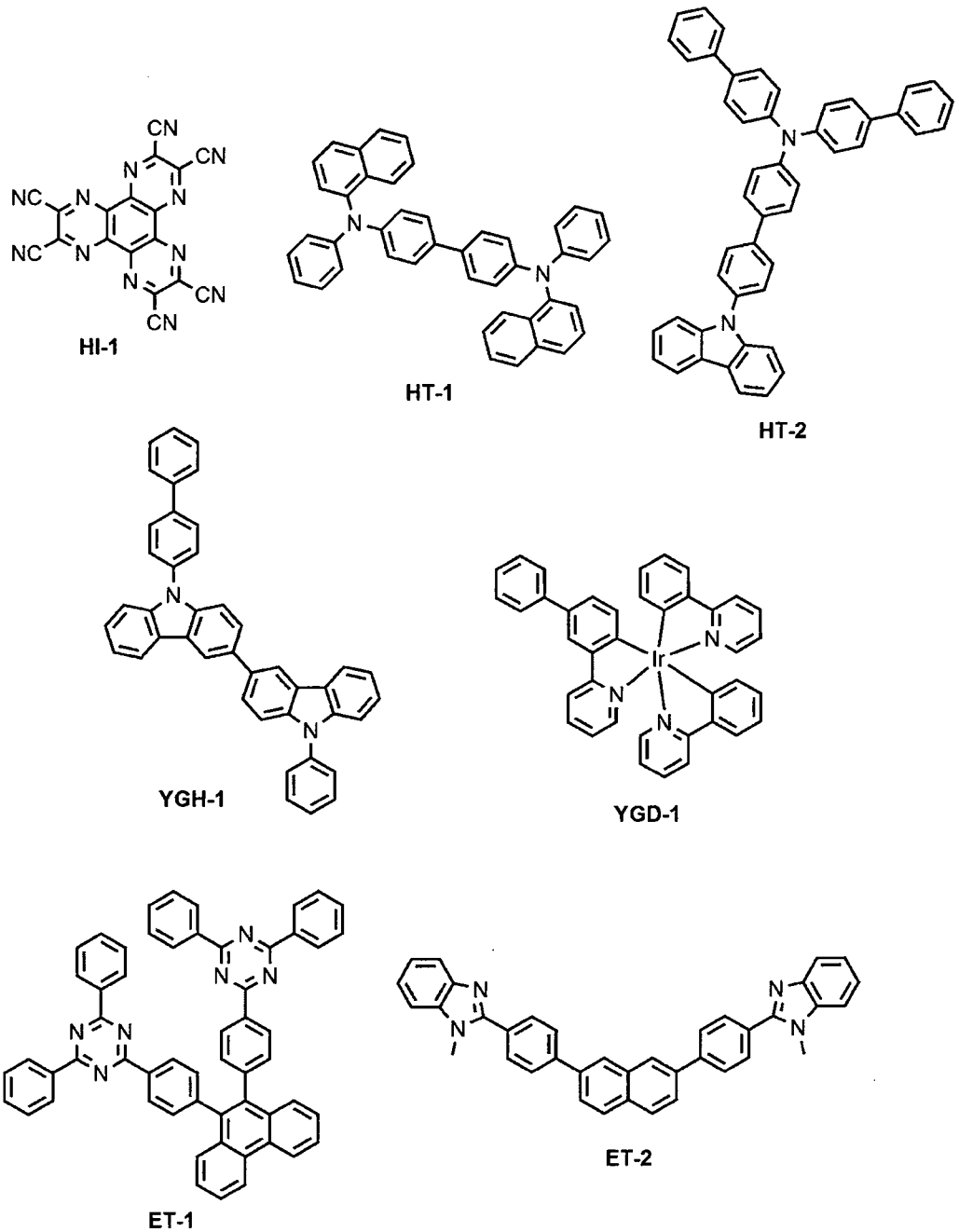
메탄올의 용제로 초음파 세척을 하고 건조시킨 후 플라즈마 세정기로 수송시켰다. 또한, 산소 플라즈마를 이용하여 상기 기판을 5분간 세정한 후 진공 증착기로 기판을 수송시켰다.

상기와 같이 준비된 ITO 투명 전극 위에 하기 HI-1 화합물을 50Å의 두께로 열 진공 증착하여 정공주입층을 형성하였다. 상기 정공주입층 위에 하기 HT-1 화합물을 250Å의 두께로 열 진공 증착하여 정공수송층을 형성하고, HT-1 증착막 위에 하기 HT-2 화합물을 50Å 두께로 진공 증착하여 전자저지층을 형성하였다.

상기 HT-2 증착막 위에 발광층으로서 앞서 제조예 1에서 제조한 화합물 1, 하기 YGH-1 화합물, 및 인광도펀트 YGD-1을 44:44:12의 중량비로 공증착하여 400Å 두께의 발광층을 형성하였다.

상기 발광층 위에 하기 ET-1 화합물을 250Å의 두께로 진공 증착하여 전자수송층을 형성하고, 상기 전자수송층 위에 하기 ET-2 화합물 및 Li를 98:2의 중량비로 진공 증착하여 100Å 두께의 전자주입층을 형성하였다.

상기 전자주입층 위에 1000Å 두께로 알루미늄을 증착하여 음극을 형성하였다.



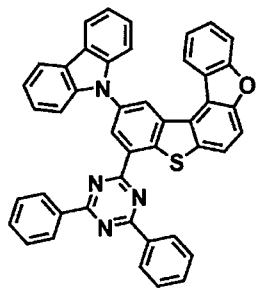
상기의 과정에서 유기물의 증착속도는 $0.4 \sim 0.7 \text{ \AA/sec}$ 를 유지하였고, 알루미늄은 $2 \text{ \AA/sec}$ 의 증착 속도를 유지하였으며, 증착시 5 진공도는 $1 \times 10^{-7} \sim 5 \times 10^{-8} \text{ torr}$ 를 유지하였다.

실시예 2 내지 실시예 10

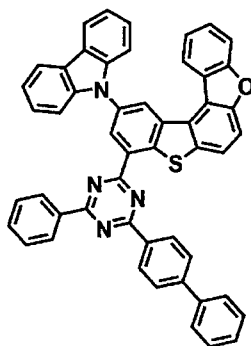
제조예 1의 화합물 1 대신 하기 표 1에 기재된 화합물을 사용하는

것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 유기 발광 소자를 제조하였다.

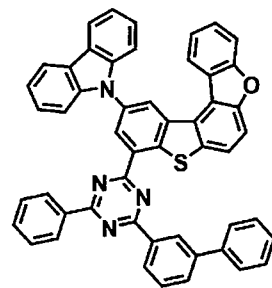
상기 실시예에 사용된 화합물의 구조는 하기와 같다.



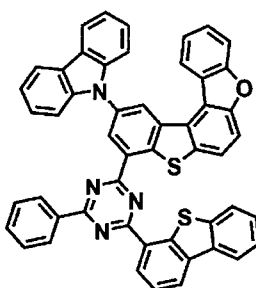
Compound 1



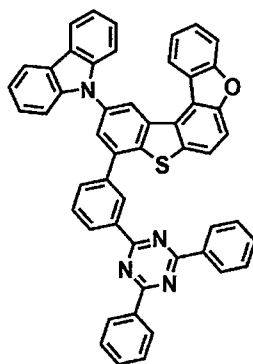
Compound 2



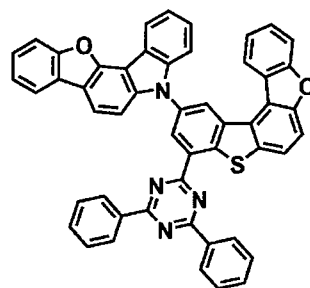
Compound 3



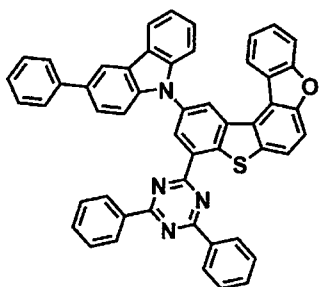
Compound 4



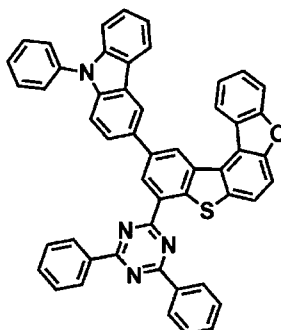
Compound 5



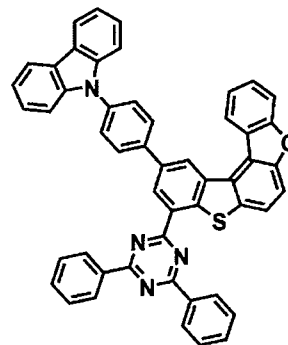
Compound 6



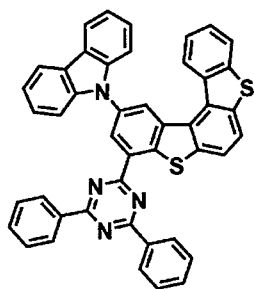
Compound 7



Compound 8



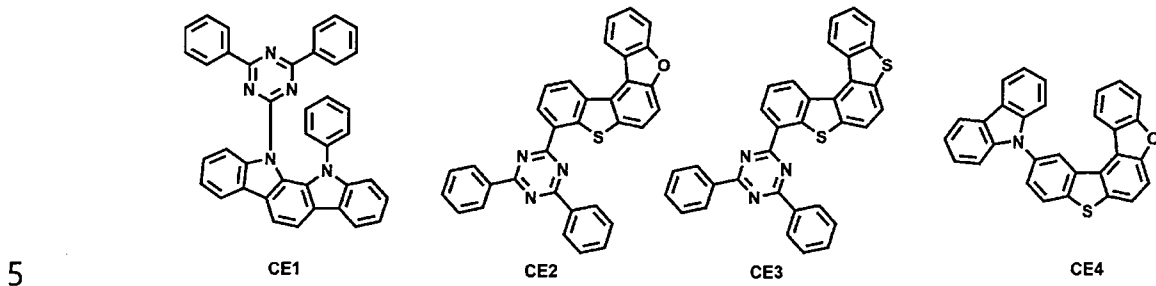
Compound 9



Compound 10

비교예 1 내지 4

제조예 1의 화합물 1 대신 하기 표 1에 기재된 화합물을 사용하는 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 유기 발광 소자를 제조하였다. 하기 표 1에서 사용한 CE1, CE2, CE3 및 CE4의 화합물의 구조는 하기와 같다.



실험예 1

상기 실시예 및 비교예에서 제조한 유기 발광 소자에 전류를 인가하여, 전류 밀도 10 mA/cm²에서의 전압 및 효율, 색좌표 및 전류 밀도 10 50 mA/cm²에서의 수명(LT₉₅)을 측정하였고, 그 결과를 하기 표 1에 나타내었다. 이때 수명(LT₉₅)은 휘도가 초기 휘도 대비 95%로 휘도가 감소되는데 소요되는 시간을 의미한다.

【표 1】

	화합물 (발광층 호스트)	전압(V) (@10mA/cm ²)	효율(Cd/A) (@10mA/cm ²)	색좌표 (x, y)	수명(h) (LT ₉₅ , @50mA/cm ²)
실시예 1	화합물 1	3.9	84	0.44, 0.54	192
실시예 2	화합물 2	4.0	83	0.45, 0.54	190
실시예 3	화합물 3	3.9	84	0.46, 0.54	198
실시예 4	화합물 4	3.8	82	0.46, 0.54	232
실시예 5	화합물 5	4.1	86	0.46, 0.53	125
실시예 6	화합물 6	4.1	81	0.46, 0.54	210
실시예 7	화합물 7	4.0	83	0.46, 0.54	151
실시예 8	화합물 8	3.9	83	0.46, 0.54	220
실시예 9	화합물 9	4.1	82	0.46, 0.53	142
실시예 10	화합물 10	4.3	80	0.46, 0.54	105
비교예 1	CE1	4.5	75	0.46, 0.54	85
비교예 2	CE2	4.0	78	0.46, 0.55	80
비교예 3	CE3	4.2	76	0.46, 0.55	70
비교예 4	CE4	5.1	62	0.44, 0.61	45

- 상기 표 1에 나타난 바와 같이, 본 발명의 화합물을 발광층의 호스트 물질로 사용한 유기 발광 소자는, 비교예 물질을 발광층의 호스트 물질로 사용한 유기 발광 소자에 비해, 효율은 동등 수준이면서 현저히 향상된 수명 특성을 나타냄을 확인할 수 있다. 이는, 상기 화학식 1로 표시되는 벤조퓨로디벤조티오펜 또는 벤조티에노디벤조티오펜 코어에 트리아진계 치환기 및 카바졸계 치환기가 동시에 결합된 구조를 갖는 화합물의 경우, 이들 중 하나의 치환기만 결합된 구조의 화합물에 비해 증가된 전하안정성을 갖기 때문인 것으로 보여진다.

10

【부호의 설명】

- | | |
|----------|----------|
| 1: 기판 | 2: 양극 |
| 3: 발광층 | 4: 음극 |
| 5: 정공주입층 | 6: 정공수송층 |
| 7: 전자저지층 | 8: 전자수송층 |
| 9: 전자주입층 | |

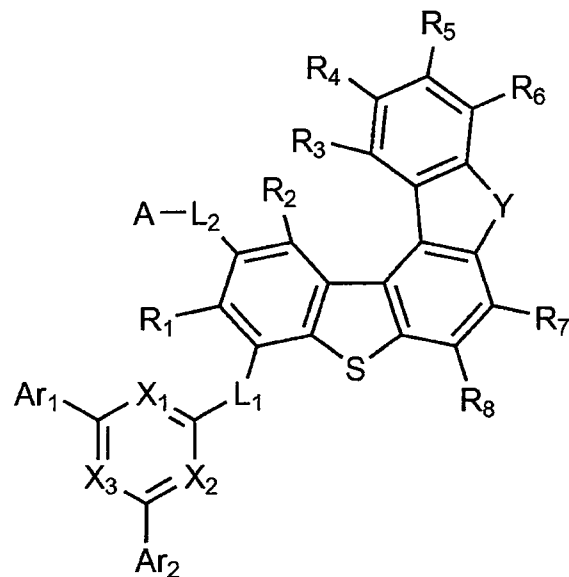
15

【특허청구범위】

【청구항 1】

하기 화학식 1로 표시되는 화합물:

[화학식 1]



5

상기 화학식 1에서,

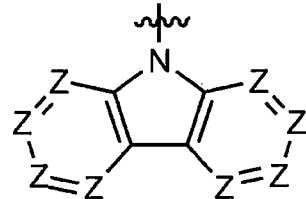
X_1 내지 X_3 는 각각 독립적으로, N 또는 CH이되, X_1 내지 X_3 중 적어도 둘은 N이고,

Y는 O 또는 S이고,

10 L_1 및 L_2 는 각각 독립적으로, 단일 결합; 치환 또는 비치환된 C_{6-60} 아릴렌; 또는 치환 또는 비치환된 O, N, Si 및 S로 구성되는 군으로부터 선택되는 헤테로원자를 1개 이상을 포함하는 C_{2-60} 헤테로아릴렌이고,

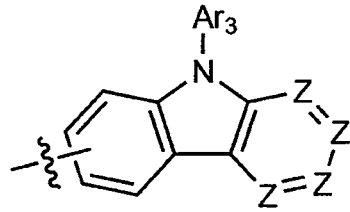
A는 하기 화학식 2 또는 3으로 표시되고,

[화학식 2]



15

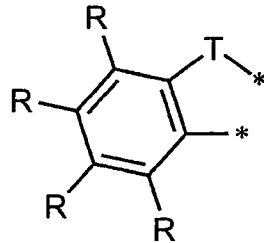
[화학식 3]



상기 화학식 2 및 3에서,

- Z는 각각 독립적으로 CR이거나; 또는 Z 중 이웃하는 2개는 하기 화학식 4와 연결되어 융합고리를 형성하는 C이고, 나머지는 각각
- 5 독립적으로 CR이고,

[화학식 4]



상기 화학식 4에서,

T는 O, S, CQ₁Q₂, 또는 NAr₄이고,

- 10 Ar₁ 내지 Ar₄는 각각 독립적으로, 치환 또는 비치환된 C₆₋₆₀ 아릴; 또는 치환 또는 비치환된 N, O 및 S로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나 이상을 포함하는 C₂₋₆₀ 헤테로아릴이고,

- R 및 R₁ 내지 R₈은 각각 독립적으로, 수소; 중수소; 할로젠; 시아노; 니트로; 아미노; 치환 또는 비치환된 C₁₋₆₀ 알킬; 치환 또는 비치환된 C₁₋₆₀ 할로알킬; 치환 또는 비치환된 C₁₋₆₀ 알콕시; 치환 또는 비치환된 C₁₋₆₀ 할로알콕시; 치환 또는 비치환된 C₃₋₆₀ 사이클로알킬; 치환 또는 비치환된 C₂₋₆₀ 알케닐; 치환 또는 비치환된 C₆₋₆₀ 아릴; 치환 또는 비치환된 C₆₋₆₀ 아릴옥시; 또는 치환 또는 비치환된 N, O 및 S로 구성되는 군으로부터 선택되는 헤테로원자를 1개 이상 포함하는 C₂₋₆₀ 헤테로아릴이고,

- 20 Q₁ 및 Q₂는 각각 독립적으로, 수소; 중수소; 할로젠; 시아노; 니트로; 아미노; 치환 또는 비치환된 C₁₋₆₀ 알킬; 또는 치환 또는 비치환된 C₆₋₆₀ 아릴이고,

*는 상기 화학식 2 또는 3의 이웃하는 2개의 Z와 연결되는 위치를 나타낸다.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

L_1 및 L_2 는 각각 독립적으로, 단일 결합, 페닐렌, 또는 비페닐릴렌인,
5 화합물.

【청구항 3】

제1항에 있어서,

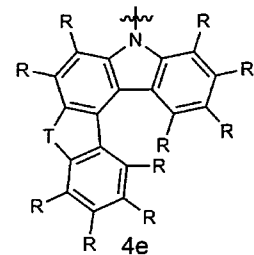
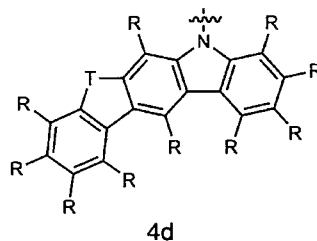
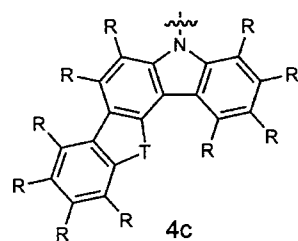
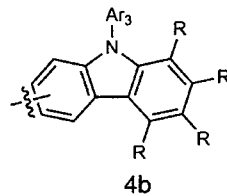
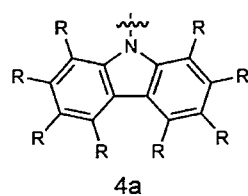
Ar_1 및 Ar_2 는 각각 독립적으로, 페닐, 비페닐릴, 터페닐릴, 나프틸,
10 페난쓰레닐, 디벤조티오펜, 또는 카바졸일인,
화합물.

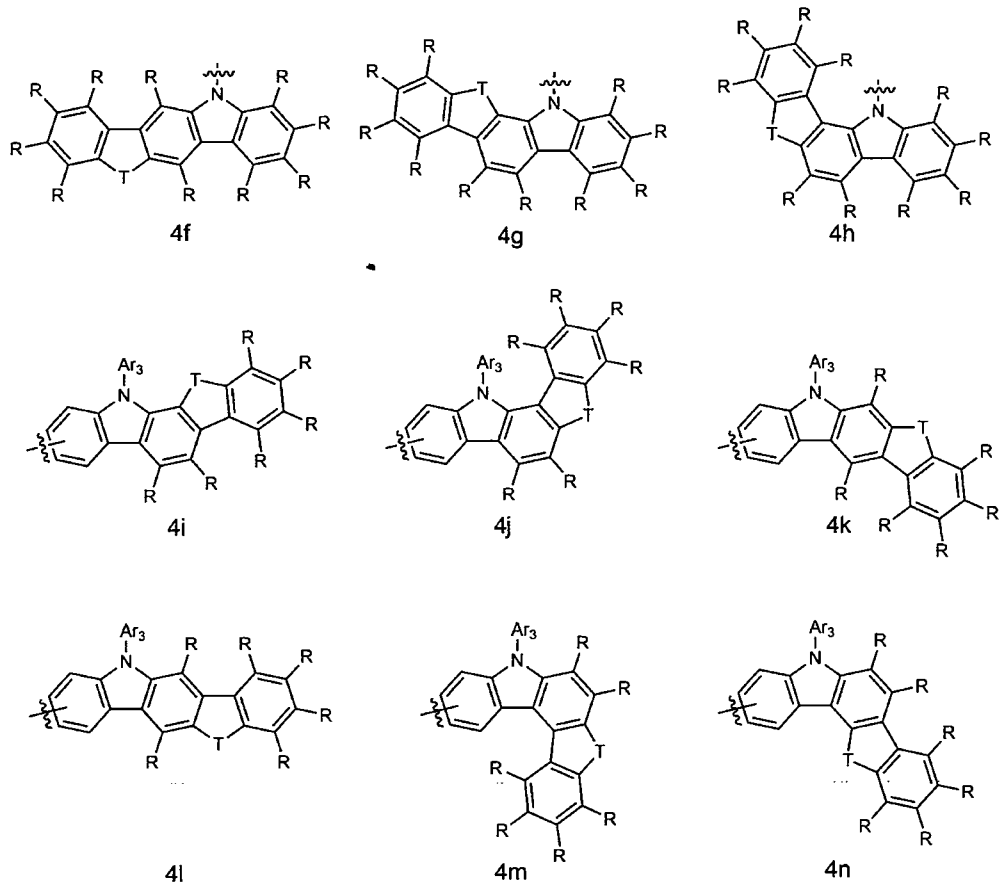
【청구항 4】

제1항에 있어서,

15 A는 하기 화학식 4a 내지 4n으로 표시되는 구조 중 선택되는 어느
하나인,

화합물:





상기 화학식 4a 내지 4n에서,

T는 O, S, CQ₁Q₂, 또는 NAr₄이고,

Ar₃ 및 Ar₄는 각각 독립적으로, C₆₋₂₀ 아릴이고,

5 R은 각각 독립적으로, 수소, 또는 C₆₋₂₀ 아릴이고,

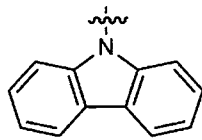
Q₁ 및 Q₂는 각각 독립적으로, 수소, C₁₋₁₀ 알킬, 또는 C₆₋₂₀ 아릴이다.

【청구항 5】

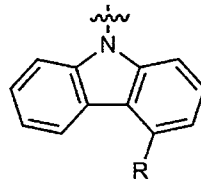
제4항에 있어서,

10 A는 하기 화학식 5a 내지 5k로 표시되는 구조 중 선택되는 어느 하나인,

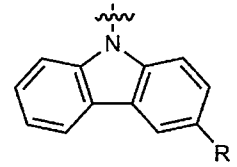
화합물:



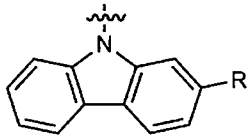
5a



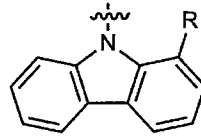
5b



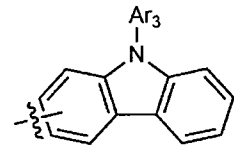
5c



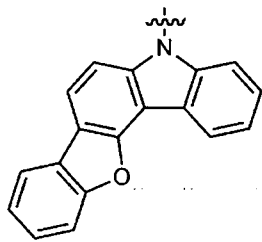
5d



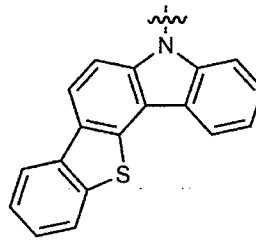
5e



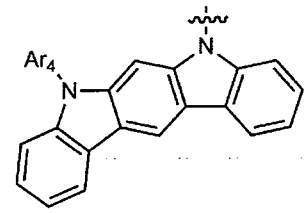
5f



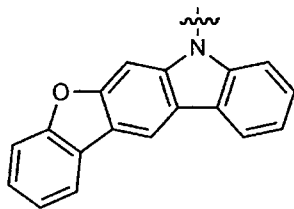
5g



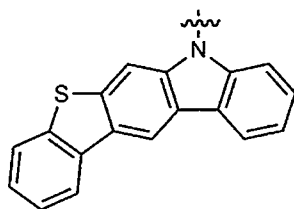
5h



5i



5j



5k

상기 화학식 5a 내지 5k에서,
R, Ar₃ 및 Ar₄는 각각 독립적으로, C₆₋₂₀ 아릴이다.

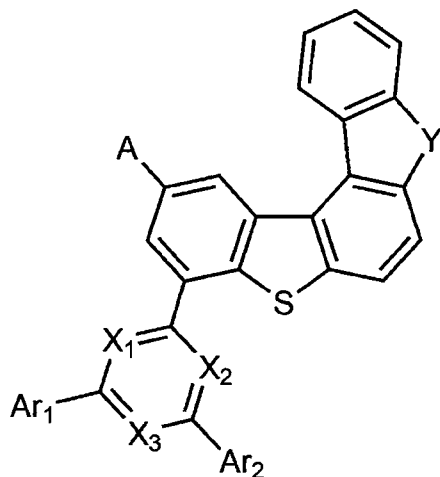
5 【청구항 6】

제5항에 있어서,
R, Ar₃ 및 Ar₄는 페닐인,
화합물.

10 【청구항 7】

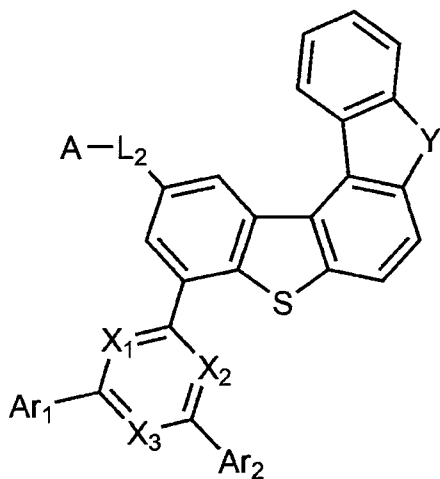
제1항에 있어서,
 상기 화합물은 하기 화학식 1-1 내지 1-3 중 어느 하나로 표시되는
 화합물:

[화학식 1-1]

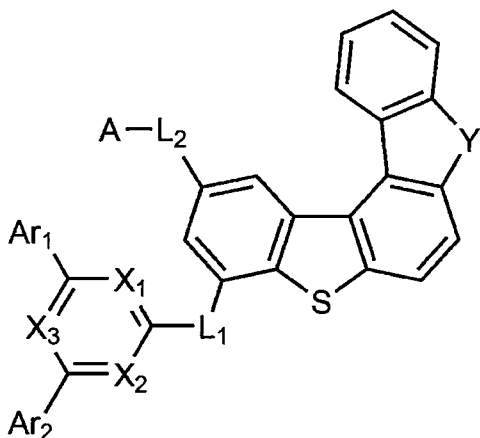


5

[화학식 1-2]



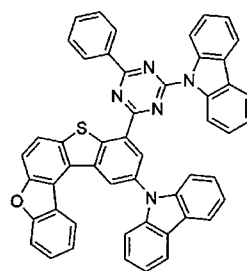
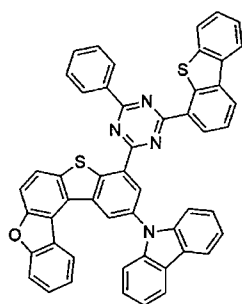
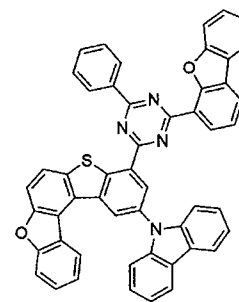
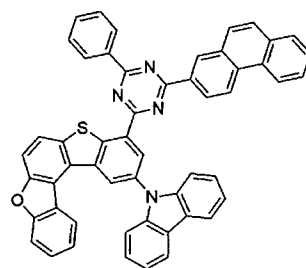
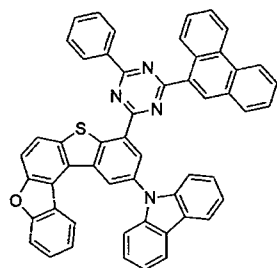
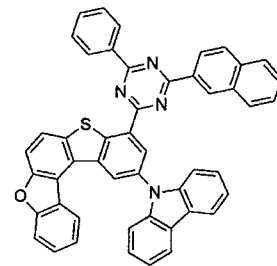
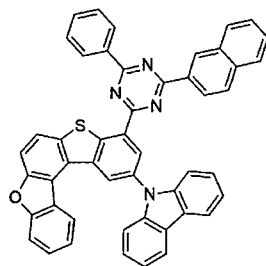
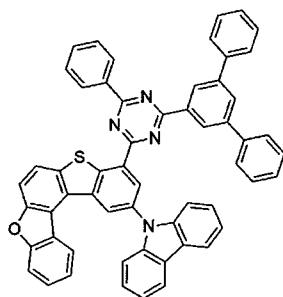
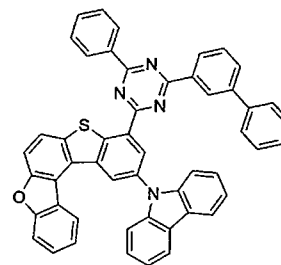
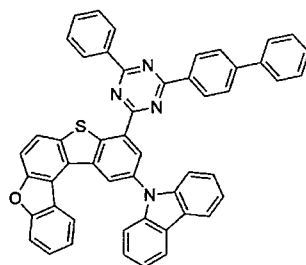
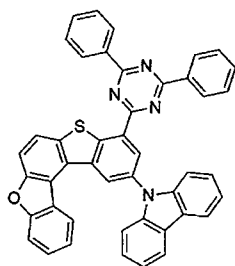
[화학식 1-3]

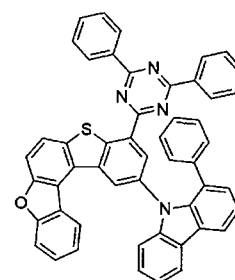
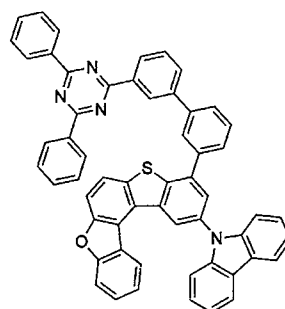
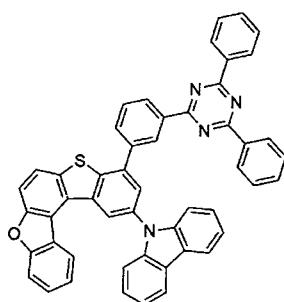
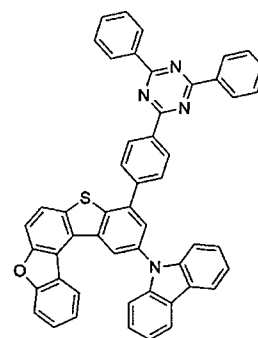
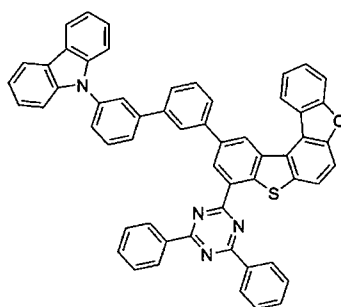
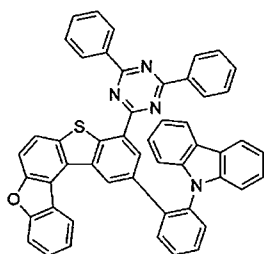
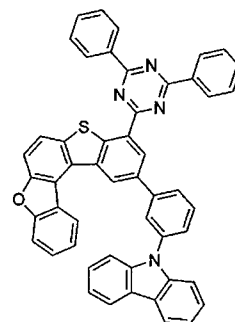
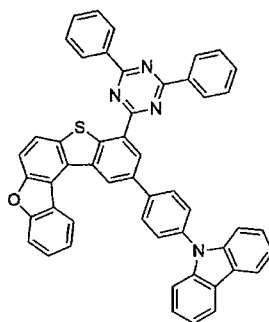
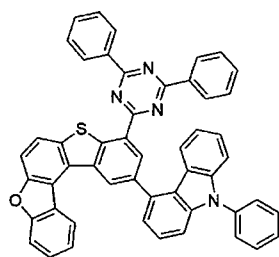
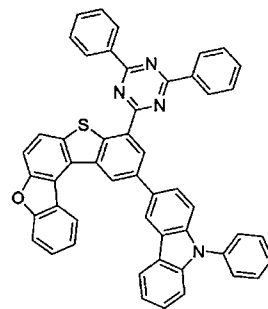
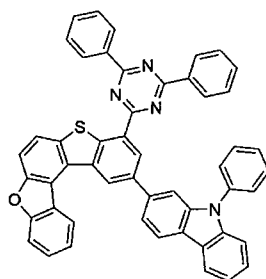
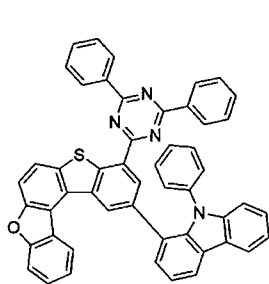


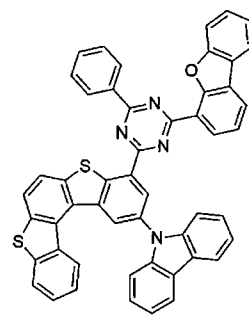
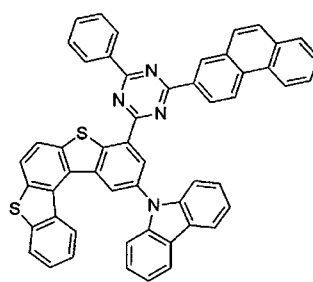
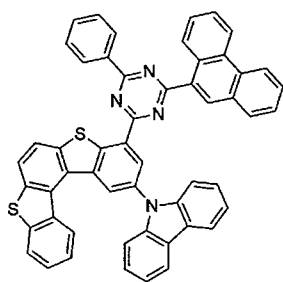
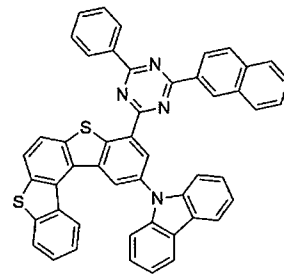
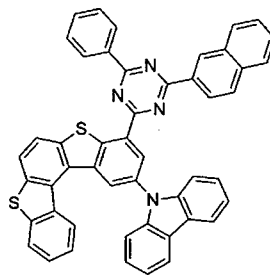
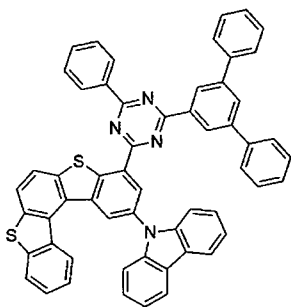
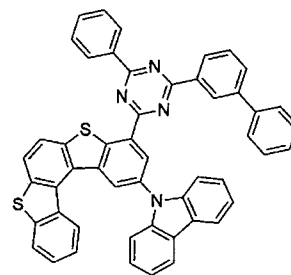
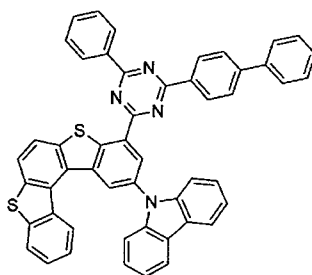
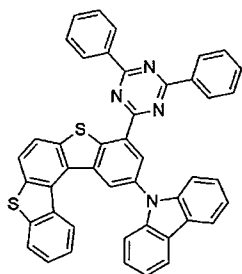
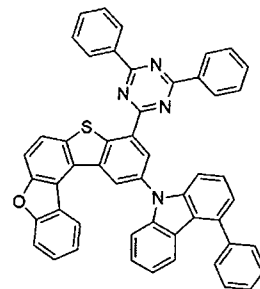
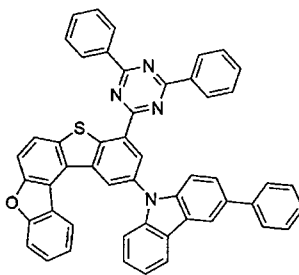
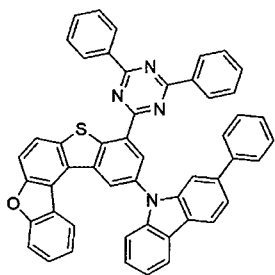
상기 화학식 1-1 내지 1-3에서,
 X_1 내지 X_3 , Y , L_1 , L_2 , A , Ar_1 및 Ar_2 에 대한 설명은 제1항에서
정의한 바와 같다.

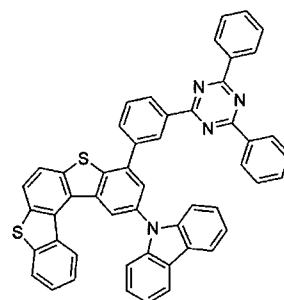
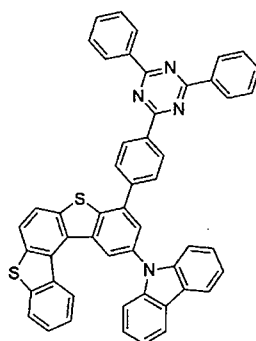
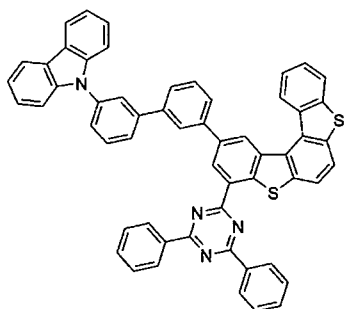
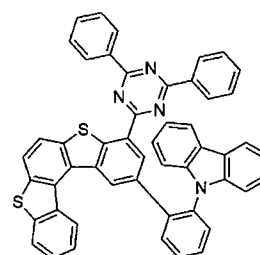
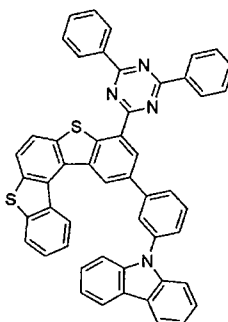
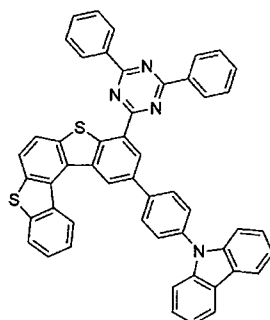
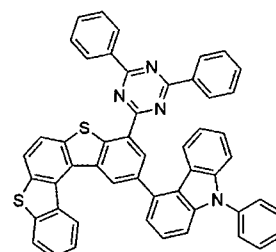
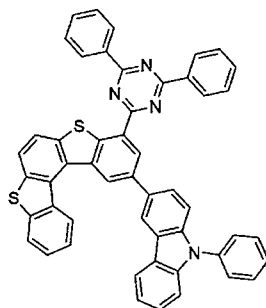
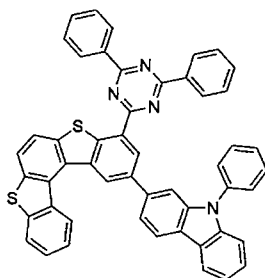
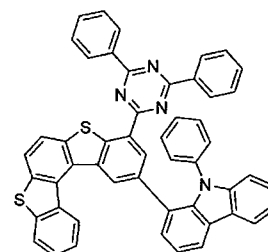
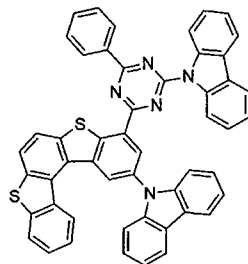
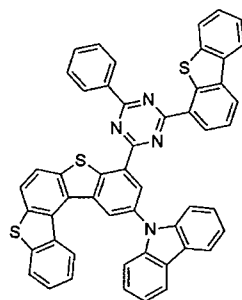
5 【청구항 8】

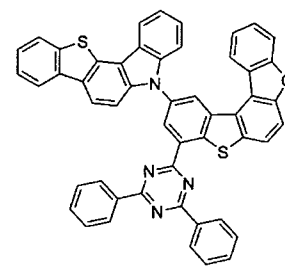
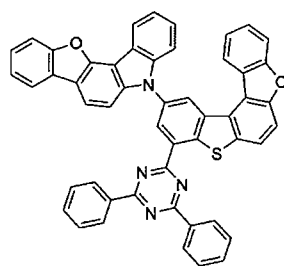
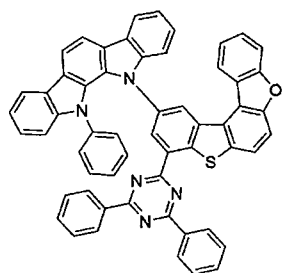
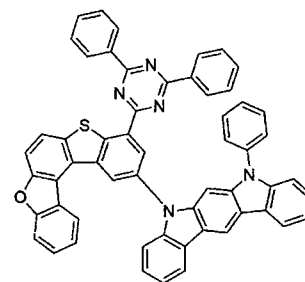
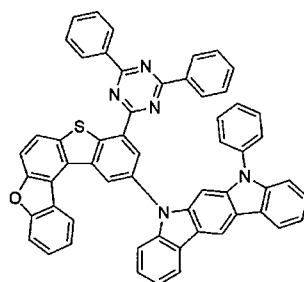
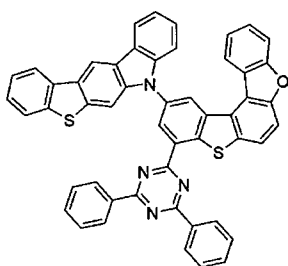
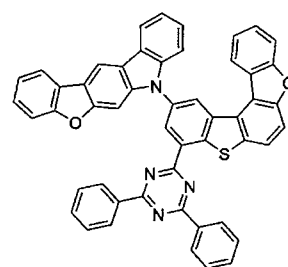
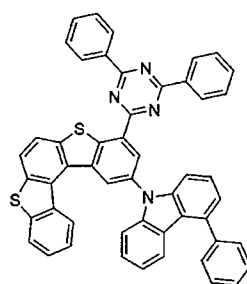
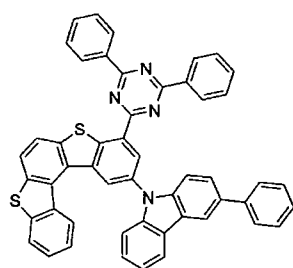
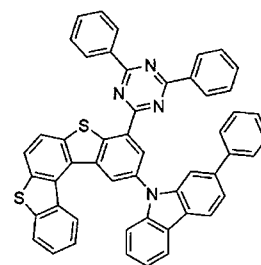
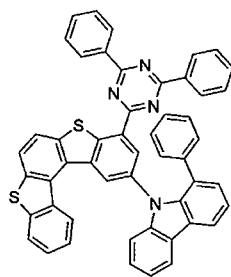
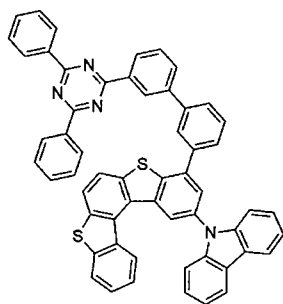
제1항에 있어서,
상기 화합물은 하기 화합물로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느
하나인, 화합물:

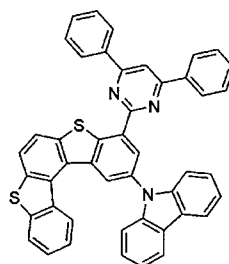
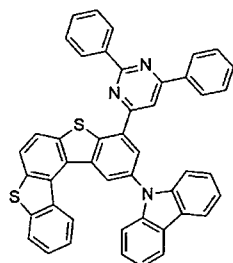
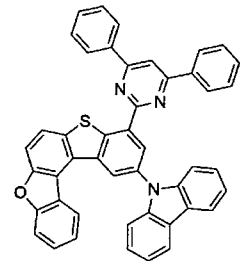
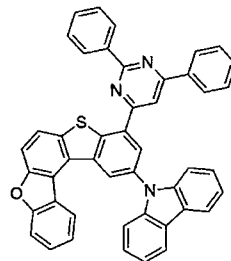
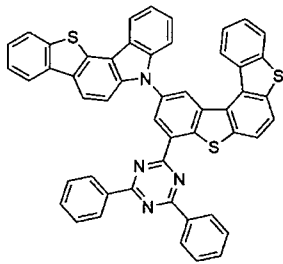
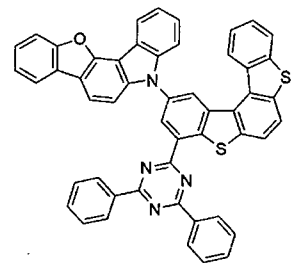
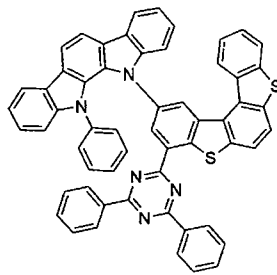
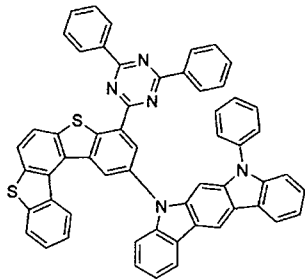
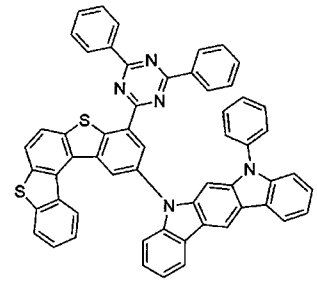
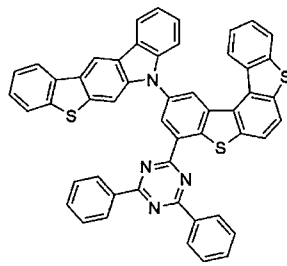
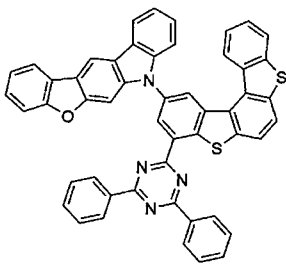












【청구항 9】

제1 전극; 상기 제1 전극과 대향하여 구비된 제2 전극; 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 구비된 1층 이상의 유기물층을 포함하는 유기 발광 소자로서, 상기 유기물층 중 1층 이상은 제1항 내지 제8항 중 어느 하나의 항에 따른 화합물을 포함하는 것인, 유기 발광 소자.

【청구항 10】

- 제9항에 있어서,
상기 유기물층은 발광층을 포함하고,
5 상기 발광층은 2종 이상의 호스트를 포함하고,
상기 호스트 중 하나가 상기 화합물인,
유기 발광 소자.

【도면】

【도 1】

4
3
2
1

5

【도 2】

4
9
8
3
7
6
5
2
1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2019/008072

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C07D 495/04(2006.01)i, C07D 411/14(2006.01)i, C07D 209/82(2006.01)i, C07D 307/91(2006.01)i, H01L 51/00(2006.01)i, H01L 51/50(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C07D 495/04; C07D 209/82; C07D 307/77; C07D 307/91; C07D 471/04; C07D 487/04; C07D 493/04; C09K 11/06; C07D 411/14; H01L 51/00; H01L 51/50

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean utility models and applications for utility models: IPC as above

Japanese utility models and applications for utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal), STN (Registry, Caplus), Google & Keywords: benzofurodibenzothiophene, benzothienodibenzothiophene, triazine, carbazole, organic light emitting device

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	KR 10-2017-0086243 A (SFC CO., LTD.) 26 July 2017 See claims 1-8; and paragraphs [0055]-[0067].	1-10
X	KR 10-2011-0018340 A (IDEMITSU KOSAN CO., LTD.) 23 February 2011 See claims 1-3, 10-11, 51-54; and paragraph [0355].	1-10
X	KR 10-1340241 B1 (IDEMITSU KOSAN CO., LTD.) 10 December 2013 See claims 7-8, 57-58; and paragraph [0231].	1-10
X	KR 10-2017-0086329 A (SFC CO., LTD.) 26 July 2017 See claims 1-7; and paragraphs [0040], [0050]-[0060].	1-10
X	KR 10-2017-0086277 A (SFC CO., LTD.) 26 July 2017 See claims 1-7; and paragraphs [0034], [0044]-[0056].	1-10



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

01 OCTOBER 2019 (01.10.2019)

Date of mailing of the international search report

01 OCTOBER 2019 (01.10.2019)

Name and mailing address of the ISA/KR



Korean Intellectual Property Office
Government Complex Daejeon Building 4, 189, Cheongsu-ro, Seo-gu,
Daejeon, 35208, Republic of Korea

Facsimile No. +82-42-481-8578

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2019/008072

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
KR 10-2017-0086243 A	26/07/2017	None	
KR 10-2011-0018340 A	23/02/2011	CN 102056911 A	11/05/2011
		CN 102056911 B	22/07/2015
		CN 105037368 A	11/11/2015
		CN 105037368 B	29/08/2017
		EP 2301926 A1	30/03/2011
		EP 2301926 B1	21/11/2018
		JP 2014-028819 A	13/02/2014
		JP 2015-145370 A	13/08/2015
		JP 5357150 B2	04/12/2013
		JP 6140205 B2	31/05/2017
		TW 201008932 A	01/03/2010
		TW 1450897 B	01/09/2014
		US 10020454 B2	10/07/2018
		US 10026907 B2	17/07/2018
		US 2009-0309488 A1	17/12/2009
		US 2011-0253995 A1	20/10/2011
		US 2012-0104943 A1	03/05/2012
		US 2015-0171334 A1	18/06/2015
		US 2016-0118602 A1	28/04/2016
		US 2017-0092877 A1	30/03/2017
		US 2018-0040835 A1	08/02/2018
		US 2018-0083205 A1	22/03/2018
		US 8049411 B2	01/11/2011
		US 8927118 B2	06/01/2015
		US 9056870 B2	16/06/2015
		US 9660203 B2	23/05/2017
		US 9847493 B2	19/12/2017
		WO 2009-148015 A1	10/12/2009
KR 10-1340241 B1	10/12/2013	CN 102056899 A	11/05/2011
		CN 102056899 B	20/11/2013
		EP 2301921 A1	30/03/2011
		JP 5238025 B2	17/07/2013
		TW 201006909 A	16/02/2010
		US 2010-0012931 A1	21/01/2010
		US 2013-0020563 A1	24/01/2013
		US 8318323 B2	27/11/2012
		WO 2009-148062 A1	10/12/2009
KR 10-2017-0086329 A	26/07/2017	None	
KR 10-2017-0086277 A	26/07/2017	None	

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC)) C07D 495/04(2006.01)i, C07D 411/14(2006.01)i, C07D 209/82(2006.01)i, C07D 307/91(2006.01)i, H01L 51/00(2006.01)i, H01L 51/50(2006.01)i																				
B. 조사된 분야 조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재) C07D 495/04; C07D 209/82; C07D 307/77; C07D 307/91; C07D 471/04; C07D 487/04; C07D 493/04; C09K 11/06; C07D 411/14; H01L 51/00; H01L 51/50 조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌 한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC 일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC 국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우)) eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템), STN (Registry, Caplus), 구글 & 키워드: 벤조퓨로디벤조티오펜(benzofurodibenzothiophene), 벤조티에노디벤조티오펜(benzothienodibenzothiophene), 트리아진(triazine), 카바졸(carbazole), 유기 발광 소자(organic electroluminescence device)																				
C. 관련 문헌 <table border="1"> <thead> <tr> <th>카테고리*</th> <th>인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재</th> <th>관련 청구항</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>KR 10-2017-0086243 A (에스에프씨 주식회사) 2017.07.26 청구항 1-8; 및 단락 [0055]-[0067] 참조.</td> <td>1-10</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>KR 10-2011-0018340 A (이데미쓰 고산 가부시기가이샤) 2011.02.23 청구항 1-3, 10-11, 51-54; 및 단락 [0355] 참조.</td> <td>1-10</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>KR 10-1340241 B1 (이데미쓰 고산 가부시기가이샤) 2013.12.10 청구항 7-8, 57-58; 및 단락 [0231] 참조.</td> <td>1-10</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>KR 10-2017-0086329 A (에스에프씨 주식회사) 2017.07.26 청구항 1-7; 및 단락 [0040], [0050]-[0060] 참조.</td> <td>1-10</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>KR 10-2017-0086277 A (에스에프씨 주식회사) 2017.07.26 청구항 1-7; 및 단락 [0034], [0044]-[0056] 참조.</td> <td>1-10</td> </tr> </tbody> </table>			카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항	X	KR 10-2017-0086243 A (에스에프씨 주식회사) 2017.07.26 청구항 1-8; 및 단락 [0055]-[0067] 참조.	1-10	X	KR 10-2011-0018340 A (이데미쓰 고산 가부시기가이샤) 2011.02.23 청구항 1-3, 10-11, 51-54; 및 단락 [0355] 참조.	1-10	X	KR 10-1340241 B1 (이데미쓰 고산 가부시기가이샤) 2013.12.10 청구항 7-8, 57-58; 및 단락 [0231] 참조.	1-10	X	KR 10-2017-0086329 A (에스에프씨 주식회사) 2017.07.26 청구항 1-7; 및 단락 [0040], [0050]-[0060] 참조.	1-10	X	KR 10-2017-0086277 A (에스에프씨 주식회사) 2017.07.26 청구항 1-7; 및 단락 [0034], [0044]-[0056] 참조.	1-10
카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항																		
X	KR 10-2017-0086243 A (에스에프씨 주식회사) 2017.07.26 청구항 1-8; 및 단락 [0055]-[0067] 참조.	1-10																		
X	KR 10-2011-0018340 A (이데미쓰 고산 가부시기가이샤) 2011.02.23 청구항 1-3, 10-11, 51-54; 및 단락 [0355] 참조.	1-10																		
X	KR 10-1340241 B1 (이데미쓰 고산 가부시기가이샤) 2013.12.10 청구항 7-8, 57-58; 및 단락 [0231] 참조.	1-10																		
X	KR 10-2017-0086329 A (에스에프씨 주식회사) 2017.07.26 청구항 1-7; 및 단락 [0040], [0050]-[0060] 참조.	1-10																		
X	KR 10-2017-0086277 A (에스에프씨 주식회사) 2017.07.26 청구항 1-7; 및 단락 [0034], [0044]-[0056] 참조.	1-10																		
☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다. ☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.																				
* 인용된 문헌의 특별 카테고리: “A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌 “D” 본 국제출원에서 출원인이 인용한 문헌 “E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가진 국제출원일 이후 “X”에 공개된 선출원 또는 특허 문헌 “L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌 “O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌 “P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌 “T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌 “X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신구성 또는 진보성이 없는 것으로 본다. “Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다. “&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌																				
국제조사의 실제 완료일 2019년 10월 01일 (01.10.2019)		국제조사보고서 발송일 2019년 10월 01일 (01.10.2019)																		
ISA/KR의 명칭 및 우편주소  대한민국 특허청 (35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사) 팩스 번호 +82-42-481-8578		심사관 이기철 전화번호 +82-42-481-3353 																		

국제조사보고서
대응특허에 관한 정보

국제출원번호

PCT/KR2019/008072

국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
KR 10-2017-0086243 A	2017/07/26	없음	
KR 10-2011-0018340 A	2011/02/23	CN 102056911 A CN 102056911 B CN 105037368 A CN 105037368 B EP 2301926 A1 EP 2301926 B1 JP 2014-028819 A JP 2015-145370 A JP 5357150 B2 JP 6140205 B2 TW 201008932 A TW I450897 B US 10020454 B2 US 10026907 B2 US 2009-0309488 A1 US 2011-0253995 A1 US 2012-0104943 A1 US 2015-0171334 A1 US 2016-0118602 A1 US 2017-0092877 A1 US 2018-0040835 A1 US 2018-0083205 A1 US 8049411 B2 US 8927118 B2 US 9056870 B2 US 9660203 B2 US 9847493 B2 WO 2009-148015 A1	2011/05/11 2015/07/22 2015/11/11 2017/08/29 2011/03/30 2018/11/21 2014/02/13 2015/08/13 2013/12/04 2017/05/31 2010/03/01 2014/09/01 2018/07/10 2018/07/17 2009/12/17 2011/10/20 2012/05/03 2015/06/18 2016/04/28 2017/03/30 2018/02/08 2018/03/22 2011/11/01 2015/01/06 2015/06/16 2017/05/23 2017/12/19 2009/12/10
KR 10-1340241 B1	2013/12/10	CN 102056899 A CN 102056899 B EP 2301921 A1 JP 5238025 B2 TW 201006909 A US 2010-0012931 A1 US 2013-0020563 A1 US 8318323 B2 WO 2009-148062 A1	2011/05/11 2013/11/20 2011/03/30 2013/07/17 2010/02/16 2010/01/21 2013/01/24 2012/11/27 2009/12/10
KR 10-2017-0086329 A	2017/07/26	없음	
KR 10-2017-0086277 A	2017/07/26	없음	